

(51)Int.Cl.⁷
H 0 1 L 27/146

識別記号

F I
H 0 1 L 27/14テ-マコト⁷(参考)
A 4 M 1 1 8

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 42 頁)

(21)出願番号 特願2000-550151(P2000-550151)
 (22)出願日 平成11年5月10日(1999.5.10)
 (85)翻訳文提出日 平成12年11月16日(2000.11.16)
 (86)国際出願番号 PCT/DE99/01436
 (87)国際公開番号 WO99/00629
 (87)国際公開日 平成11年11月25日(1999.11.25)
 (31)優先権主張番号 19821974.1
 (32)優先日 平成10年5月18日(1998.5.18)
 (33)優先権主張国 ドイツ (DE)

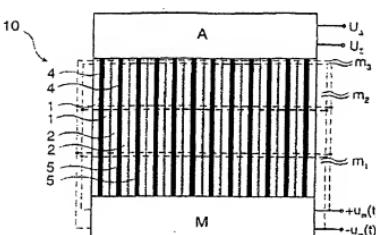
(71)出願人 シュワルテ ルドルフ
ドイツ連邦共和国 ネトフェン ディー
57250 クロイツターレル ストラッセ
56
(72)発明者 シュワルテ ルドルフ
ドイツ連邦共和国 ネトフェン ディー
57250 クロイツターレル ストラッセ
56
(74)代理人 弁理士 重信 和男 (外2名)
Fターム(参考) 4M18 AA10 AB10 BA09 CA02 DA40
DB09 DB15 FA08 GA10

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 电磁波の位相及び振幅を検出するための装置並びに方法

(57)【要約】

本発明は、電磁波の位相及び振幅を検出するための装置に関する。本装置は、当該電磁波に対して敏感である少なくとも2つの変調フォト・ゲート(1, 2)から成っている。本装置は、また前記変調フォト・ゲートに対し開闢付けられかつ感光性でない累算ゲート(4, 5)から成り、そして累算ゲートが読み出し装置に接続され、変調フォト・ゲートは変調装置に接続され得る変調フォト・ゲート(1, 2)と累算ゲート(4, 5)のための電気接続部を有している。前記変調装置はそれら変調フォト・ゲート(1, 2)の当該電位を互いに増減させ、かつ所望の変調関数に対応して好ましくは一定の累算ゲート(4, 5)の当該電位をも増減させる。本発明は、複数の変調フォト・ゲート(1, 2)と累算ゲート(4, 5)が、PMDピクセルをグループ形式で形成する長くて狭い平行ストリップの形態を探るよう構成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 好ましくは光学領域における電磁波及びその近赤外線領域及び紫外線領域における電磁波の位相及び振幅を検出するための装置であって：当該電磁波に対して敏感（感光性）である少なくとも2つの変調フォト・ゲート（1，2）と、それらの変調フォト・ゲートに対して関連付けられるものであり、感光性ではなくシェーディングされるものでもないように成した、累算ゲート（4，5）と、それらの変調フォト・ゲート（1，2）及びそれらの累算ゲート（4，5）のための電気接続部であり、当該後者は、読み出し装置に対して接続され得るように成し、当該前者は、それらの変調フォト・ゲート（1，2）の当該電位を互いに増減させ、且つ所望の変調閾数に対応してそれらの累算ゲート（4，5）の好ましくは一定である当該電位をも増減させる変調装置に対して接続され得るように成した、当該電気接続部とを含んで成るように成した、当該電磁波の位相及び振幅を検出するための装置であって： P M Dピクセルをグループ形式で形成する長くて狭い平行ストリップの形態を探って複数の変調フォト・ゲート（1，2）及び累算ゲート（4，5）が設けられるように成し、それらの累算ゲートは、読み出しダイオードの形態を探って、好ましくはそれぞれの事例において当該陰極を当該読み出し電極として備えるように成したということで特徴付けられる、当該電磁波の位相及び振幅を検出するための装置。

【請求項2】 それらの変調フォト・ゲートの当該幅は、それらの累算ゲートの当該幅よりも大きいように成したということで特徴付けられる、請求項1に記載の装置。

【請求項3】 それらの個々の変調フォト・ゲートの当該幅は、当該波長の大きさのオーダーにあり、或いは詳細には、遠赤外線領域に関しては、それらの変調フォト・ゲートが敏感である当該電磁放射の当該波長以下でもあるように成したということで特徴付けられる、請求項1又は請求項2に記載の装置。

【請求項4】 それらの変調フォト・ゲート（1，2）及びそれらの累算ゲート（4，5）の当該ストリップ長さは、それらの変調フォト・ゲートが敏感である当該電磁放射の当該波長の10倍以上であり、好ましくは50倍以上であるように成したということで特徴付けられる、請求項1から3の1つに記載の装置

【請求項5】 対を為して平行に相互に併置される関係で複数の変調フォト・ゲートが設けられるように成し、そのような対のそれらの変調フォト・ゲート（1，2）の各々は、もう1つの変調接続部に対して接続され、それらの変調フォト・ゲート（1，2）は、プッシュ・プル関係で変調されるように成し、それぞの累算ゲート（5，4）は、1対の変調フォト・ゲート（1，2）と次の更なる隣接する対の変調フォト・ゲート（2，1）との間に配列されるように成し、それぞの累算ゲート（4，5）に対して直に隣接するそれらの2対の当該変調フォト・ゲート（1，2）は、それらの変調がプッシュ・プル・モードで行われるようにして、それらの変調接続部に対して接続され即ち電気的に接合されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から4の1つに記載の装置。

【請求項6】 複数の変調接続部（m₁，m₂，m₃）は、それらのストリップの当該長さに沿って実質的に等しい間隔で配列され、それらの変調フォト・ゲート（1，2）に対して接続されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から5の1つに記載の装置。

【請求項7】 それらの累算ゲート（4，5）に対してそれらの累算ゲートに向かう当該側面において直に隣接するそれらの変調フォト・ゲートは、それらの電磁波に関して高い伝導性のものであり且つ透過性が全くないか又は非常に低いものである接触ストリップによるカバーリングを部分的に含むように成したということで特徴付けられる、請求項1から6の1つに記載の装置。

【請求項8】 当該装置は、1つ又はそれ以上のピクセル・エレメントを有するように成し、1つのピクセル・エレメントは、複数対の変調ゲート（1，2）及び累算ゲート（4，5）を含んで成るように成し、異なった変調電圧における隣接ピクセル・エレメントのそれらのストリップ方向は、好ましくは互いに対して直角であるように成し、当該ストリップ方向に直交する方向において、それらのピクセルの各端部は、内側に配設される次の累算ゲート（4，5）に対して隣接する少なくとも1つのそれぞの変調フォト・ゲート（1，2）によって画成されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から7の1つに記

載の装置。

【請求項9】 それらの累算ゲート接続部は、ピクセルのそれらのストリップの各端部において設けられるように成し、各々の第2の累算ゲートは、2本の読み出しラインのそれぞれの一方（例えばK+）に対して接続され、その他の累算ゲートは、それらの接続ラインのそれぞれのもう一方（K-に対応する）に対して接続されるように成し、それらの読み出しラインは、評価回路に至るように成したということで特徴付けられる、請求項8に記載の装置。

【請求項10】 2つのピクセル・エレメント（10, 10'）は、それらのストリップが平行であり且つ相互に直に併置される関係で配列されるように成し、それらの2つのピクセル・エレメント（10, 10'）の相互に併置されるそれらの端部又は側面を画成するものである当該相互に直に隣接する変調フォト・ゲートは、プッシュ・プル・モード又は位相遷移関係で選択的に調整可能である1対の変調フォト・ゲート（1, 2）を形成するように成し、それによって、当該サイズの2倍のものである単一のピクセル・エレメント、或いは例えば同相信号及び矩形信号の2つの独立した計測手順の何れかが、それらの2つのピクセル・エレメントによって実行可能であるように成したということで特徴付けられる、請求項8又は請求項9に記載の装置。

【請求項11】 4個のピクセル・エレメントは、1つの長方形の中に配列されるように成し、当該長方形の中においてそれぞれに対角的に対向する関係で配設されるそれらのピクセルの当該ストリップは、互いに対して平行に延在するが、直に隣接するそれらのピクセル・エレメントの当該ストリップは、互いに対して垂直に延在するように成し、それらの変調接続部は、隣接するピクセル・エレメント（10）の変調が詳細にはそれぞれの事例における好ましくは90度に渡る位相ずれ関係である位相ずれ関係において実施され得るようにして接続されるように成したということで特徴付けられる、請求項8及び請求項9の1つに記載の装置。

【請求項12】 それらのピクセル・エレメント（10）の各々は、それぞれに実質的に正方形の形状のものであり、それらの4個のピクセル・エレメントは、組み立てられて、正方形を形成し、或いは実質的に八面体の形状が形成され

るようにしてそれらのコーナーが補足的に切り取られる当該正方形を形成するようになつたということで特徴付けられる、請求項9に記載の装置。

【請求項13】 それらの4個のピクセル・エレメントは、選択的に個々に結合され(4象限操作)、対角的な関係における2つの様式で結合され(2象限操作)、或いは4つの様式で結合される(1象限操作)ように成し、4象限操作及び2象限操作の場合には、当該サーフェイス・エレメントの当該勾配即ち垂直方向ベクトルが、補足的に評価されるように成したということで特徴付けられる、請求項12に記載の装置。

【請求項14】 それらの変調フォト・ゲート及びそれらの累算ゲート及びそれに付随する信号評価周辺機器及び変調周辺機器は、CMOS技術又はBICMOS技術を使用して、部分的にはオン・チップとして且つ部分的にはマルチ・チップ・モジュールとして製造されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から12の1つに記載の装置。

【請求項15】 それらの変調フォト・ゲート(1, 2)の全体に渡って配列されるものは、専らそれらの変調フォト・ゲート(1, 2)の上においてピクセル・エレメントの当該表面に入射する光線のすべてに実質的に焦点を結ぶストリップ・レンズであるように成したということで特徴付けられる、請求項1から14の1つに記載の装置。

【請求項16】 複数のピクセルが、線形配列又はマトリクス配列において配列されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から15の1つに記載の装置。

【請求項17】 線形配列又はマトリクス配列において、3D機能性を備えたPMDピクセル及び2D機能性を備えた従来的なCMOSピクセルが、混合モードで使用されるように成し、ピクセル情報の特には隣接する項目である様々な項目が、データ融合及び補間装置に対して送られ、その深部画像を再構築するように成したということで特徴付けられる、請求項1から16の1つに記載の装置。

【請求項18】 好ましくは、当該配列に入射する当該光線をそれらの個々のピクセルの当該感光表面に対して実質的に集束させるマイクロレンズが、各々

のPMDピクセルに付随して存在するように成したということで特徴付けられる、請求項16及び17に記載の装置。

【請求項19】 当該装置は、カメラの中における感光性の画像記録エレメントとして使用されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から18の1つに記載の装置の使用。

【請求項20】 当該装置は、信号捕捉、処理及びノイズ抑制のための周波数及び位相感知性ミキシング・エレメント即ち相関エレメントとして、光学的な信号処理において使用されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から18の1つに記載の装置の使用。

【請求項21】 画像が形成されることになるシーンが変調機能に従って変調された光線を照射されるように成し、それらの変調フォト・ゲート(1, 2)は、同じであるがここではバイポーラ式即ちプッシュ・プル式である変調機能に従って変調されるように成し、選択的に、それらのピクセルの2象限又は4象限ピクセルの半分に関して、正弦変調の場合には90度の位相ずれ変調が実施され、直交変調の場合にはピット幅の変調が実施され、それらのフォト・ゲート電圧のPN変調の場合にはチップ幅の変調が実施されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から18の1つに記載の装置を操作する方法。

【請求項22】 当該装置は、好ましくは高度に集積された光学的PLL回路又はDLL回路において使用されるように成し、好ましくは、光線バリア装置において、時間経過カメラ、光学的リモート・コントロール装置、及びデータ光線バリア装置におけるPLL配列として使用され、更には様々な変調モードを備えた光学的通信におけるデータ信号の再生のためのものとしても使用されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から18の1つに記載の装置の使用。

【請求項23】 当該装置は、特にPN変調に拠って、IQ-PMD受信器をベースとする2Q-PMD-DLLを備えた光学的PLL回路又はDLL回路において使用されるように成し、デジタルPN符号化されたデータ信号は、マルチ・チャネル選択、マルチ・ターゲット検出、及び位相遷移時間解像度における最高度の感度のために使用されるように成し、その差出力電圧は、それらの光

電流の量的な差に関する差違、即ち $U_d = \text{定数} \cdot (|i_a - i_b| - |i_c - i_d|)$ として形成され、ループ・フィルタ又はデジタル・レギュレータによって当該電圧制御式マルチ・バイブレータの制御パラメータとして当該チップ周波数に対してフィードバックされるように成し、当該PN符号化された1/0データ・シーケンスの当該データ信号は、手順に拠る当該復元ワード・クロックによつて再生されるように成し、それによつて、当該総和器(41)の中において、それらの光電流のそれらの差の合計、即ち $U_s = \text{定数} \cdot (|i_a - i_b| - |i_c - i_d|)$ は、当該総和器の中に含まれた短期インテグレータによってPNワード長さに渡つてそれぞれに形成されるように成したということで特徴付けられる、請求項1から18と22の1つに記載の装置の使用。

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、電磁波の位相及び振幅を検出するための装置に関するものであり、より詳細に好ましくは光学領域における電磁波及びその近赤外線領域及び紫外線領域における電磁波の位相及び振幅を検出するための装置に関するものであって
： 当該電磁波に対して敏感（即ち感光性）である少なくとも2つの変調フォト・ゲートと、それらの変調フォト・ゲートに対して関連付けられるものであり、感光性ではなくシェーディングされるものでもないように成した、累算ゲートと、それらの変調フォト・ゲート及びそれらの累算ゲートのための電気接続部であり、当該後者は、読み出し装置に対して接続され得るように成し、当該前者は、変調装置に対して接続され得るように成した、当該電気接続部とを含んで成るように成し、当該変調装置は、それらの変調フォト・ゲートの当該電位を互いに増減させ、且つ所望の変調閾数に対応してそれらの累算ゲートの好ましくは一定である当該電位をも増減させるように成した、当該電磁波の位相及び振幅を検出するための装置に関するものである。

【0002】

そのような装置は、「光混合デテクタ」（PMDと省略される）という用語によって、ドイツ特許出願196 35 932. 5号及び197 04 496 4号及び上述の2件の出願に基づく国際特許出願PCT/DE97/01956号から公知である。

【0003】

上述のそれらの出願は、同じ発明人に関するものであり、本件出願の出願人のものとして書類提出されており、その中で説明されるものが光混合デテクタの操作の基本モード、性能及び実行可能な使用である限り、先行するそれらの出願の全開示内容が参照される。従って、本発明は、光混合デテクタに関するそれらの基本的な機能について論議するものではなく、主として、既に公知であるそれらのピクセルがそれによって最適化されるように成した光混合デテクタの特殊な構成及び使用に関するものである。

【0004】

対象によって変調され、反射され或いは放出される当該光線を受ける際に、その同じ変調機能によって変調されるそれらの変調フォト・ゲートによって実行されるその固有の混合手順の故に、当該公知のPMDsは、当該対象によって反射された当該電磁波の当該遷移時間を検出するだけでなく、従来的なカメラにおける場合のように適当な光学システムによって保証される横方向位置の解像度をも直接に検出する適所に位置するものであり、それと同時に、記録されたそれらのピクセルについての間隔情報の各項目を直接に獲得する適所に位置するものでもある。したがって、それらのPMDsは、費用の掛かる評価手順及び記録手順を様々な角度において必要とすることなく、表面に関する直接の3次元的な測量及び計測を許容するのである。

【0005】

当該公知のPMDsの事例において十分な感度及び深部解像度を達成するためには、それらのピクセル表面は、十分に大きくなければならないものであり、その結果、個々の画像の当該記録持続時間の間に、十分な電磁放射が当該対象の様々な表面領域から受け取られることになるのであり、当該間隔情報が、それらの変調フォト・ゲートにおいて異なった瞬間に生じて、直に隣接するそれらの累算ゲートによって累算されるように成した、異なった個数の電荷キャリアによって最終的に獲得されるとき、適当な個数の電荷キャリアが当該感光体材料の中において形成されることになるのである。

【0006】

それは、それらの個々のピクセルの当該面積に関して所定の最小限の寸法を必要とするものである。当該対象の非常に鋭い明暗境界線が当該画像の中において形成されるという事実の故に、それらの従来的なPMDsに関連して、問題が生じる可能性もある。そのような明暗境界線が隣接する変調フォト・ゲートの間の当該境界線領域の上に偶然に位置するならば、隣接するそれらの累算ゲートにおける異なった個数の電荷キャリアが、それに従って、深部情報に関する不適当な解釈を導き出すという相関的な結果を生じるのである。

【0007】

更に、比較的大きな面積のものである当該種類の感光体ピクセル・エレメント

における当該遷移時間は、比較的長いものであり、当該変調周波数の当該バンド幅即ち限界数値は、通常、数メガヘルツから最大でも 100 メガヘルツという領域内にのみ位置するものである。特に、例えばオプト・エレクトロニクスの分野及び光学的な信号通信におけるものである対応する光感知デテクタの使用の場合には、少なくとも 1 GHz というバンド幅が所望されることになる。

【0008】

更に、例えば特には経済的な理由のためにそれらの同じピクセルによって種々の操作モードを実行するというような種々の用途の場合には、それらの P M D ピクセル及び P M D 配列に関する高レベルの機能性及び柔軟な使用もまた好適であるということになる。

【0009】

以上のこと留意すれば、本発明の目的は、本件明細書の冒頭の部分で規定されたような特徴を有して、著しく改善されたバンド幅を有するように成し、画像形成表面における明暗境界線の更なる解釈ミスが、少ししか起こりそうにないか又は排除さえされてしまうように成し、実際的な使用における高レベルの機能性及び経済性が達成されるように成した、電磁波の位相及び振幅を検出するための装置を提供することである。

【0010】

当該目的は、それらの累算ゲートと同様にそれらの変調フォト・ゲートもまた、長くて狭い平行ストリップの形態を採って相互に併置される関係で設けられるように成し、当該ストリップが、 P M D ピクセルをグループ形式で形成するように成し、それらの累算ゲートが、読出しダイオードの形態を採るように成して、達成される。

【0011】

それらの変調フォト・ゲート及びそれらの累算ゲートが長くて狭い平行ストリップの形態を採るという事実と、平行して直接に相互に併置される関係におけるそれらの配列は、それらのゲートのための非常に短いチャネル長さ（当該変調ゲート・ストリップ幅は、 M O S ドラインジスタ技術から、当該ゲート長さと呼ばれる）を生じることになる。それらの変調フォト・ゲートの中又は下において形成

されるそれらの自由電荷キャリアは、隣接する当該累算ゲートに対する当該ゲート長さの当該短い間隔だけ、当該ストリップ方向に対して横方向にのみドリフトするものであり、それに関連して、当該ドリフトは、それらの変調フォト・ゲートにおける当該変調電圧の当該部分において適当な電場によって支持される。結果として、当該ドリフト時間は、例えば、1ナノ秒以下になり、それに従って、1 GHzという使用可能な変調バンド幅を達成することが可能になるのである。それらの変調フォト・ゲートのそれらの個々のストリップが、更にはそれらの累算ゲートもまた、比較的狭いものであるとしても、それらの対応する長さの故に、それにも関わらず、それらは、十分に大きな感光領域を提供することが可能であるが、更にその一方で、交互に配列される複数のストリップ形状の変調フォト・ゲート及び累算ゲートは、互いに接続されて、その光学的充填ファクタをほぼ2倍にするユニットを形成することが可能になるということが認識されるであろう。そのようにすれば、実質的に如何なるピクセル形状及びピクセル寸法も、変調バンド幅に関する限定なしで、当該種類のストリップ構造によって実現されることが可能なのである。

【0012】

本発明の当該好適な実施例は、以下のように規定する。それらの個々の変調フォト・ゲートは、隣接するそれぞれの累算ゲートのものよりも大きい幅のものであるが、更に、それらの変調フォト・ゲートの当該幅は、可能であれば、それらのエレメントによって検出される当該変調された光線のための当該画像形成光学システムの当該回折限界よりも小さいものであるべきであり、好ましくは、当該光線即ち当該電磁波の当該波長又は少数の波長の大きさのオーダーのものであるべきであるというのである。これは、回折効果の故に、鋭い明暗境界線が、もはや、偶然にも、ブッシュ・ブル関係で変調される2つの隣接する変調フォト・ゲートの間の当該領域に入ることはないということを意味する。その一方で、当該横方向におけるそれらの変調フォト・ゲートの当該小さな寸法は、シャドー即ち明暗境界線が、それらのゲートの当該全幅に渡って分散されなければならず、両者の隣接するゲートが、未だに光線によって等しく影響されるということを規定する。更に、非常に長く、それに対応して狭いものである変調フォト・ゲートを

使用すれば、いずれにせよ、明暗境界線が、それらのストリップの当該方向に対して正確に平行に延在するということは、殆ど起こり得ないことがある。しかしながら、それらのストリップに対する当該僅かな傾きがあれば、いずれにせよ、プッシュ・プル関係で変調される2つの隣接する変調フォト・ゲートは、その画像が形成されるそれぞれの対象の当該明部及び当該暗部からの光線によって実質的に等しく影響されることになる。

【0013】

それらの変調フォト・ゲートの当該ストリップ長さ及びそれらの累算ゲートの当該ストリップ長さもまた、可能であれば、少なくともその幅の10倍から100倍のものであるべきである。複数の変調フォト・ゲート及び累算ゲートによって形成されるそれらのピクセルの当該幅は、全体として、当該長さとほぼ同じ大きさのオーダーのものであるべきであり、それは、約10個から100個のストリップが、相互に併置される関係で配列されることになり、その約3分の1が累算ゲートであり、約3分の2が変調フォト・ゲートであるということを意味する。しかしながら、本発明のもう1つの実施例では、各々の2つの累算ゲートの間ににおける当該潜在的な構成を改善すべく、対応するストリップの形態を探って3つ又はそれ以上の変調フォト・ゲートを配列することもまた実行可能であり、その場合には、当該中央の変調フォト・ゲートは、変調されないものであるべきである。更に、本発明のもう1つの好適な実施例は、それらのストリップに対する当該横方向において観察すると、ピクセルの中には、1つの累算ゲート・ストリップを交互に備えた2つの変調フォト・ゲート・ストリップが常に存在するようになしたものであり、直に相互に併置されるそれらの2つの変調フォト・ゲートは、それらの電位が互いに對してプッシュ・プル関係で変調され得るようにして接続されるようにならし、それらの累算ゲートの各々は、好ましくは一定であるより低いエネルギー・ポテンシャル、即ち例えは当該光電子に関する正電位を有するようにならし、当該正電位は、それらの2つの変調フォト・ゲートの下において形成される当該電荷キャリアが主として当該変調フォト・ゲートの当該側面に対してドリフトするということを規定するようにならし、それは、当該低いエネルギー・ポテンシャル値を受け入れて、そこからそれらの2つのストリップの当該側

面に配列された当該累算ゲートへと進むように成したものなのである。その場合、1つの累算ゲートのそれぞれの側面に配列されるそれらの2つの変調フォト・ゲート・ストリップは、プッシュ・プル関係で変調されるものであり、即ち、所定の瞬間ににおいて、1つの累算ゲートが、それに隣接する両方の変調フォト・ゲート・ストリップから同時に電荷キャリアを受け入れるのであるが、隣接するそれぞれの累算ゲートは、当該瞬間には正確により高い電位にあって、非常に少数の電荷キャリアだけが当該累算ゲートへと進むように成した、2つの変調フォト・ゲート・ストリップに隣接しているのである。従って、それぞれの各々の第2の累算ゲートもまた、それと同じ1つの読出しラインに対して接続され、その残りの累算ゲートは、もう1つの読出しラインに対して接続されるのであり、それらの2本のラインの当該総和信号は、当該受信した光線の当該振幅を複製するものであるが、当該差信号は、当該受信した光線の当該変調と、プッシュ・プル関係において直接に隣接するそれらの変調フォト・ゲートの同じ変調機能による同時変調とから生じる当該相関信号の当該値を直接に示すものである。それは、上述のそれらの2つの変調フォト・ゲートの間において補足的に配列されることになり、例えば一定の中間電位に配設されることが可能であるように成した、第3の変調フォト・ゲートを使用するときにも全く同様な様式で行われるものであるが、それらの隣接する2つの変調フォト・ゲートは、当該中央ゲートに対するプッシュ・プル関係で当該変調電圧を増減され得ることになる。そのようにすれば、当該電位構成が、幾分か平滑化されることも可能であり、それらの電荷キャリアの単方向性転移に関する効率性のレベルもまた、当該変調電圧のそれぞれの現在値に従って増大され得るのである。

【0014】

本発明に拠れば、それらの累算ゲートは、読出しダイオードという形態を採るものである。

【0015】

当該実行可能な電圧読出しモードでは、それらのプッシュ・プル変調電圧に従って配分されるそれらの光電荷は、それらの累算ゲートのキャパシタンスにおいて記憶されるものであり、この事例では、当該ブロッキング方向において接続さ

れるそれらの読み出しダイオード（例えば、p-n-ダイオード又はショットキー・ダイオード）の当該バリア層キャパシタンスにおいて記憶されるよう成し、高抵抗読み出し装置によって確かめられるのである。

【0016】

本文において選択されている当該現在読み出しモードでは、到着する当該光電荷は、当該読み出し電極の実質的に変化しない電位によって当該読み出し回路に対して直接に伝達される。

【0017】

本発明の使用に関する現時点において流通している半導体材料の場合と同様に、電子移動性は、正孔即ち欠陥電子のものより大きいものであり、好ましくは、光電子が、それらの変調フォト・ゲートによって方向的に変調され、当該変調電圧に従ってそれらの累算ゲート又は読み出しダイオードに対して配分されるのである。この場合には、読み出しダイオードの各陽極が、好ましくは、共通のアース電位にあるが、それらの陰極は、正電位にあって、当該読み出し回路に対してそれぞれに読み出し電極 K₊ 及び K₋ として接続されることになる。

【0018】

上述の2種類の累算ゲート K₊ 及び K₋ は、本発明に従って並列に機能するよう成し、且つ、例えば、正の変調フォト・ゲート電圧が、それらの K₊ 累算ゲートにおける光電荷の濃縮或いはそれらの K₋ 累算ゲートにおける光電荷の減損を生じるようにして、本発明に従って、最高のバンド幅の新規な P M D ピクセルを形成するように成した、累算ゲート及び変調ゲートのグループの中において互い違いに位置するものであり、それらの累算ゲートは、その両面電荷累算の故に2倍に使用され、それらのピクセルの内部に対する光学的な充填の度合いをもほぼ2倍にして、寄生静電容量を著しく削減するのである。

【0019】

本発明の1つの好適な実施例では、変調フォト・ゲート及び累算ゲートの複数の平行ストリップをそれぞれに含んで成る2つのピクセルは、直接に相互に併置される関係で配列されるものであり、ここでは2象限ピクセルと呼ばれる。これに関しては、当該横方向において、それらのピクセルは、それらの累算ゲートの

間における場合のように、1対のものによってではなく、当該方向におけるその最後の累算ゲート・ストリップに隣接する個々の変調フォト・ゲートによって、それぞれに終端されるということが指摘されるべきである。2つのそのようなピクセルが直接に相互に併置される関係で配列される場合には、それらの2つのピクセルのそれぞれの1つのそれぞれの変調フォト・ゲートをそれぞれに形成するように成したそれらの2つの末端ストリップもまた、相互に併置される関係になるものであり、それら自体が分離されるそれらの2つのピクセルは、ここで、相互に併置されるそれらの2つの変調フォト・ゲートが互いに對してプッシュ・プル関係で変調されるようにして、変調されることが可能になり、それは、一体的な大きいピクセルがそれらの2つの個々のピクセルから形成されるように成して、同じ変調の電圧及び位相において当該ピクセルの表面積を効果的に2倍にするということになるのである。しかしながら、この構成では、当該大きなピクセルのそれらの2つの2分割部分は、原則として、互いに独立して変調されるので、その変調関数は、当該他方のピクセルに対して、90度又は適當な遅延T₀だけ、当該一方のピクセルに関する位相即ち遷移時間において等しく有効に転移されることも可能である。これは、同相信号及び矩形信号が同時に計測されるということを意味するものであり、そのような様式において、当該相関関数の当該位相位置についての完全な情報が、並列に且つ同時の関係で獲得されるのである。

【0020】

当該事例において、それらの累算ゲート接続部即ち端子は、好適には、それらのピクセルの1つの当該端部においてそれぞれに設けられる。それらの変調フォト・ゲート接続部即ち端子は、好ましくは、それらのピクセル表面の両端即ちストリップ端部からのプッシュ・プル・ストリップ・ラインの形態を探って設けられるものであり、より詳細には、とりわけ特に長いストリップの場合、それに加えて、それぞれの事例における横方向に延在するプッシュ・プル・ストリップ長さの故に、複数のものとして等距離の間隔を置いて設けられるのである。それは、当該変調信号が、当該変調フォト・ゲートの当該電気的表面抵抗の故に当該ゲートの当該長さの全体に渡って減衰されて変形されるものであり、確認される当該相関関数もまた、それに対応して変形されるということを防止することになる

【0021】

本発明の特に好適な1つの実施例は、4個のピクセルが長方形又は正方形の中に配列されて、1つのユニットを形成するように成し、より詳細には、互いに対してそれぞれに対角的な関係で当該正方形又は長方形の中に配列されるそれらのピクセルのストリップは、互いに対して平行に延在するが、直接に隣接して配設されるそれらのピクセルの当該ストリップは、互いに対して垂直に延在するようになし、それによって、特に厄介な相互の過剰連結の影響を実質的に回避するようにして配列されるものである。この実施例は、本文では、4象限(4Q)一PMDピクセルと呼ばれる。それらのピクセルそれ自体が正方形である場合には、それらの4個の象限によって構成される当該ピクセル・エレメントもまた、正方形であり、対角的に相互に対向するピクセルの間におけるものとしての変調の位相シフトによって、それらの同相信号及び矩象信号のプッシュ・プル相関数値を検出することも同時に可能であるということになる。

【0022】

更には、それらの変調フォト・ゲート及びそれらの累算ゲートの上において、詳細には結果として円柱レンズであるそれに対応するストリップ形状のレンズが、配列されるように成し、それらのレンズは、それらのレンズに衝突する当該光線をそれらの変調フォト・ゲートに対して集束させるものであり、感光性でないそれらの累算ゲートによって占拠されるそれらの表面コンポーネントもまた、当該光線の収率に対して更に有効に貢献するように成した、本発明の更なるもう1つの実施例もまた好適である。連結して変調される当該光線が、本質的に比較的狭いバンドである場合、当該ストリップ構造は、波動説に従った当該連結ファクタが、著しく大きいものであるか、或いは当該反射ファクタが、幾何光学に従つたそれらの当該反射ファクタに対応するものよりも著しく小さいように成して、そのような光線の平均波長に合わせて寸法形成されることも可能である。当該事例では、それらの変調フォト・ゲートにおける改良を包含して、そのような計測を助長させることも実行可能である。

【0023】

複数のピクセルが線形配列又はマトリクス配列の何れかを形成すべく互いに結合されることも可能であり、それに関連する1つの好適な実施例は、それらの個々のピクセルの上において、マイクロ・レンズが配列されるように成し、それらのマイクロ・レンズは、それらのピクセルの間に位置していて、それらのマイクロ・レンズを介する評価に貢献するものではない各領域に対しても部分的に導かれる当該入射光を、それらの感光性ピクセル表面に対して導くように成したものである。

【0024】

同じものが4回であるか又は異なった変調を備えるように成した、4Q-PMDピクセルは、すべての4個の相関数値の平均化によって、それらの4個の正方形のサブ・ピクセルのそれらの集結のポイントを計測することが可能であり、それと同時に、当該4Q-PMDピクセルの当該全体の位相即ち遷移時間を確認することも可能である。それらの4個の個々の集結ポイントの遷移時間は、当該事例では、当該画像形成表面エレメントの当該勾配即ち垂直方向ベクトルを供給するものであり、当該3D表面の改良した補間が1つの配列の隣接するそれらのピクセルの間において計測されるということを許容するものもある。

【0025】

最後に、本発明の特に好適な1つの実施例は、それらのピクセル、即ちそれらの個々の変調フォト・ゲート及びそれらの累算ゲートがCMOS技術を使用して実装されるように成したものである。それは、対応する各エレメントの大量生産を許容するように成し、それと同時に、当該評価電子機器及び当該変調電子機器のような当該周辺機器のオン・チップ式及びマルチ・チップ式のモジュール統合をも許容するように成した、非常に安価且つ有効に確立した技術である。

【0026】

CMOS技術では、2D機能性を備えた従来的なCMOSピクセル（いわゆる2Dピクセル）及び3D機能性を備えたPMDピクセル（いわゆる3Dピクセル）の両方が、混合的な構成における線形配列又はマトリクス配列の中に組み込まれることが可能である。この事例では、特にはピクセルの隣接項目に関するものである様々なピクセル情報が、それらの2Dピクセルについてのカラー情報及び

それらの3D-PMDピクセルについての当該3D深部及び2Dグレー値の情報に関する各項目による当該完全な3Dカラー／深部画像の迅速な再構成に関連して、下流に配置されるデータ融合及び補間の装置において評価され得るものであり、それは、光学的計測手順に関する全く新しい選択肢を、オートメーション、対象確認、セキュリティ技術及びマルチメディア技術において提供するのである。

【0027】

本発明の更なる利点、特徴、及び実行可能な用途は、好適な実施例及び添付図面に関するこれ以降の説明から明白になるであろう。

【0028】

図1の中央部分において示されるものは、垂直方向の平行ストリップの列であり、それらの明色のストリップは、感光性で半透明の変調フォト・ゲートを再現しているが、参照番号4及び5で表示されるそれらの暗色のストリップは、淡色で不透明に覆われる累算ゲート即ち読出しゲートに対応する。それらの狭い黒色の垂直方向ストリップは、隣接する変調フォト・ゲート1及び2の間における絶縁分離面を表わしている。

【0029】

それらの変調フォト・ゲートは、ここでは、参照番号1及び2で識別されている。何故なら、同じ参照番号1で示されるそれらの変調フォト・ゲートもまた互いにに対してプッシュ・プル関係で変調されるものであるが、続いて参照番号2で示され、それに関しては全く同じであるよう成了したそれらの変調フォト・ゲートの当該電位は、それらの変調フォト・ゲート1に対してプッシュ・プル関係で変調されるものだからである。その下側部分におけるMは、詳細には当該変調電子機器及び当該変調電圧供給源の接続部又は端子8である当該変調回路を概略的に示している。図1の当該上側部分におけるAは、当該読出し電子機器及び接続部又は端子及びそれらの累算ゲート4及び5に対してそれぞれに接続される信号処理装置である当該読出し回路を概略的に示している。この事例では、すべての累算ゲート4、即ち1つおきの累算ゲートは、第1の共通読出しラインに対して接続され、それらの間に配設されるそれらの累算ゲート5は、もう1つの共通読

出しラインに対して接続される。当該読出し回路は、当該総和信号 U_z を確認するものであり、それらの累算ゲート 4 及び 5 のそれらの光電荷からの当該差 U をも確認する。 U_z は、時間に関して平均化されるそれらの全光電荷の総和に関する計測値であるが、 U は、それらの累算ゲート 4 及び 5 即ち K_+ 及び K_- のそれぞれにおけるそれらの光電荷の当該差に関する計測値である。それらの変調フォト・ゲート 1 は、それらの変調フォト・ゲート 2 が当該電圧端子 $-U_m(t)$ に対して接続されるとき、例えば当該電圧端子 $+U_m(t)$ に対して接続される。当該変調電圧は、好ましくは、擬似ノイズ電圧であり、或いは擬似ランダム電圧でもあるが、適當な限定された相関関数及び十分なワード長さを備えた任意のその他の符号化した変調信号を使用することもまた実行可能であろう。

【0030】

それらの変調フォト・ゲート 2 が高い電圧レベルにある間に、それらの変調フォト・ゲート 1 が低い電圧レベルにある場合、図 3 及び図 4 の当該実施例では光電子であるそれらの電荷キャリアは、主として即ちほぼ排他的にそれらの累算ゲート 4 に対してのみ通されることになり、その間、それらの累算ゲート 5 は、電荷を全く或いはほぼ全く捕集しないのである。それらの電圧条件が逆転され、結果として、それらの変調フォト・ゲート 2 が低い電位にある間に、それらの変調フォト・ゲート 1 が高い電位にある場合には、それらの電荷キャリアは、ほぼ排他的にそれらの累算ゲート 5 を経由してのみ流出することになる。形成されたそれらの電荷キャリアが、その画像が当該ピクセルによって記録される対象のものと同じ関数に従って変化するようになって、照射によって形成される時間に関する実質的な変動を包含する場合、それは、それらの電荷キャリアがそれらの感光面において形成された瞬間にについての情報を供給するものである。当該対象の照射もまたそれによって変調されるものである同じ変調関数によるそれらの変調フォト・ゲートの変調は、その後、当該 U 信号として、当該画像形成ピクセルの当該間隔に関する情報の各項目を包含する当該相関関数を供給することになる。

【0031】

理解されるであろうように、それらのストリップは、それらの長さと比べて非常に狭いものであり、その点に関して、それに対応する状態は、それらの図面に

おいて縮尺通りには示されていない。その反対に、実際には、それらの個々のストリップは、それらの幅に比べて実質的にはより長いものでさえあるということになるのである。それらの狭いストリップは、非常に短いゲート長さ、即ち電荷キャリアに対する非常に短いドリフト間隔に対応するものであり、それらの電荷キャリアは、変調フォト・ゲート1又は2の下においてそれらの読み出しゲート4又は5の一方に対して形成される。それに対応する短いドリフト時間は、それに応する迅速な変調信号を許容するものであり、結果として高いバンド幅を生じるのである。

【0032】

しかしながら、それらの長手方向におけるそれらの変調フォト・ゲートの当該抵抗に起因して測定精度に悪影響を及ぼさないために、複数の変調接続部即ち端子 m_1 、 m_2 及び m_3 は、好ましくは当該ピクセルの当該頂部側面からそれぞれの変調フォト・ゲート1及び2まで、互いにに対して等しい間隔を置いてそれぞれに平行に接続されるものであり、変調は、それらの接続ライン m_1 、 m_2 及び m_3 のそれらの各接続ポイントにおいて同時に実施され得ることになるのであり、その点に関して、前記接続部の個数は、それらの要求事項に従って更にはそれらの個々のストリップの当該長さにも従って変更され適応され得るということが認識されるであろう。

【0033】

代替的に或いはそれに加えて、この問題は、それらの累算ゲート4、5に対してそれらの累算ゲートに向かう当該ストリップの側面において直接に隣接するそれらの変調フォト・ゲートが、好ましくは当該変調フォト・ゲートに対して添付される金属フィルムという形態を探るようにして、高い導電性を有するものであり且つそれらの電磁波に関しては全く或いは非常に僅かしか透過性を有するものでないよう成了した接触ストリップを使用して、例えば当該変調フォト・ゲート幅の4分の1から3分の1の間のものであるストリップ形状のカバーリングを部分的に包含するように成し、当該計測が本発明に従ってそれらの円柱レンズによって当該ピクセル領域内に当該光線を集束させるように適応されるならば、解決されることが可能である。

【0034】

更に、それらの変調フォト・ゲート1及び2は、当該底部におけるMによって示される当該ブロックからの端部接続部を直接に包含することもまた可能である。

【0035】

図2は、図1において示された当該ピクセル・エレメント10と比べてその幅がそれぞれに半分だけのものである2つの同じピクセル・エレメント10、10'によって構成されるように成した、ピクセルを概略的に示している。明快にするために、それらの補足的な変調接続部m₁、m₂及びm₃は、ここでは示されていないが、これらもまた明白に存在し得るものである。

【0036】

これらのピクセル10、10'のそれらの2つのストリップ・フィールドは、直接に相互に併置される関係で配列されるものであり、2つの個々のフォト・ゲート2及び1は、それぞれに、それらの2つのピクセル10、10'の間の当該境界面におけるその中心において相互に併置される関係で配設される。それらのピクセル10、10'の各々は、それ自身の変調電圧供給源を有するものであり、それ自身の読出し回路及びそれ自身の読出しラインをも有する。当該ピクセル10'のそれらの変調電圧は、当該ピクセル10の当該ストリップ2が当該ピクセル10'の当該ストリップ1に対するプッシュ・プル関係で変調されるようにして、当該ピクセル10のものに関連して印加されるものであり、それらの2つのピクセル・エレメントは、上述の図1の当該大型のピクセル10とちょうど同じようにして協働する。しかしながら、当該ピクセル10'の当該変調電圧を、当該ピクセル10の当該変調電圧に対して90度だけ位相ずれされるものとして選択することもまた実行可能であり、それは、同相信号及び矩象信号に対応する。従って、ここでは、それらの個々の電圧、及び当該変調及び当該評価回路は、「同相」に関する当該インデックスIを付け足して表示され、それに対応する各回路及び当該ピクセル10'の各電圧シンボルは、「矩象」に関する当該補足的なインデックスQによって表示されるのである。

【0037】

図3は、図2において示された当該ダブル・ピクセルの特殊な物理的構造を概略的に示している。このダブル・ピクセルは、共通の基板の上に配設されるものであり、それらの個々の変調フォト・ゲート層、絶縁層、及び累算ゲート層の当該配列及びシーケンスは、図1において示された当該大型ピクセルの当該事例においてもまた包含されたであろう当該配列と異なるものではないということが理解されるであろう。ただ、それらの電気接続部は、それらの右側及び左側のピクセル2分割部分のためのものとして互いに完全に分離されているのであり、当該右側2分割部分の中に配列されたそれらの変調フォト・ゲートの変調は、当該左側2分割部分の中に配列されたそれらの変調フォト・ゲートの変調から独立して選択されるということが実行可能であり、それは、前述のように、それらの信号を同相信号及び矩形信号に分離することを許容して、当該PMDピクセルの融通性を向上させることになるのである。

【0038】

図4は、これもまた本質的には図2における当該平面図に対応するものであるが、それらの個々のストリップ・エレメントが当該配列の全体を拡大して表示し得るようにしてそれらの長さに関して途切れるものとして示されるように成し、その一方で、当該変調回路に対するそれらの変調フォト・ゲートの個々の接続部、及びそれらの累算ゲート4及び5に対するそれらの読み出し回路の個々の接続部が補足的に詳細に示されるように成した、単純な平面図である。

【0039】

図5から図7は、更なる変調フォト・ゲート3が、図1から図4に関連して既に説明されたように、それらの変調フォト・ゲート1及び2の間において補足的に設けられるように成した、本発明の更なる1つの代替的な実施例を示している。この事例において、図5から図7の各々の右側におけるそれらの回路シンボルは、この中央変調フォト・ゲートが一定の電位に保たれ、それに対して、それらの変調フォト・ゲート1及び2が当該変調閾値に従ってそれらの電位を増減されるということを示している。それは、結果として、概ね平滑化された電位構成及び更に有効なチャネル分離効果、より高いドリフト速度及び変調出力のより低いレベルを生じることになる。

【0040】

この点に関して、図5は、図3に類似しているが、当該ピクセルがこの場合は複数の部分に分割されないように成した、断面図である。図5は、埋設n層を備えて、当該絶縁材料の中に埋め込まれる変調ゲート電極をも備えるように成した、有益な構成を示しているものであり、それは、部分的に重複するゲート構造と比べて非常に小さい構造であるという理由で好都合なのである。図6は、図4に類似した上からの図面を示すものであり、図7は、この光混合デテクタPMDの斜視図を示している。

【0041】

図8は、ストリップ形状の変調フォト・ゲート及び累算ゲートによって構成され、各々が実質的に正方形の形状のものであり、これもまた全体として正方形であるピクセルを形成するものとして組み立てられるように成した、4個のピクセル・エレメントを示しているものであり、互いに対しそれぞれに対角的な関係で配列されるそれらの象限の中におけるそれらのストリップは、互いに対して平行に延在するが、それらは、隣接する象限の間では互いに対して垂直に延在する。それは、異なった隣接する変調信号に関する相互の過剰結合及び変造を実質的に抑制する。当該配列において、それらの評価回路は、当該正方形のピクセル面の外側に配列されることが可能である当該正方形のそれらの側面に向かって移動される。この事例においても、それらの変調フォト・ゲートの変調は、好ましくは、ここでもまた変調電圧信号によって行われるものであり、当該変調電圧信号は、相互に対角的な関係における2つの象限に関しては、その他の2つの対角的に配列される象限に対して、90度だけ位相ずれされるか、或いはPM変調の場合にチップ幅T_{チップ}だけ遅延されるように成し、それは、結果として、同相信号及び矩形信号の同時計測を生じることになる。当該中心において部分的に重複するそれらの変調電圧ラインは、1象限操作の場合には、閉ざされることが可能であり、2象限操作の場合、それらは、水平方向及び即ち直方向においてのみ接続されることが可能であり、4象限操作の場合、それらは、開いていることが可能である。しかしながら、4個の同じ変調信号を包含し、従って好適に接続されるラインをも包含する当該状況では、別個に4回の読み出しを設けるということも

また有益である。遷移時間計測のために必要とされる当該IQ数値の対もまた、当該1象限の操作モードにおいて時間多重様式で確認されることが可能である。その代替的なヘテロダイン・プロセスでは、それらの4個の相関関数は、当該ピート周波数と一緒に通されることが可能であり、そのようにすれば、間隔情報についての各項目が、確認され得ることになる。

【0042】

図9は、図8において示されたような種類の2×8個のピクセルから成るパネル即ちフィールドを示している。ここでは参考番号100で概略的に示されているこれらのピクセルの各々の上に配列されるものは、当該ピクセル・フィールドの全体によってカバーされる当該表面に衝突する当該光線を実質的にそれらのピクセルの実際の感光面に対して集束させるようにして機能するマイクロ・レンズ6である。当該図面は、それらの個々のピクセルの上におけるそれらのストリップに対して平行に延在するようにして配列されるように成し、それらのストリップ・レンズに衝突する当該光線がそれらの累算ゲートの間の各領域に対してのみ、即ちそれらの変調フォト・ゲートに対してのみ集束されるようにして当該ピクセル面の全体をカバーするように成した、ストリップ・レンズを示してはいない。

【0043】

図10は、本発明に従ったそれらのピクセル100を装備される3Dカメラの原理を示している。この具体例ではPN(擬似ノイズ)ジェネレータであるジェネレータ11は、ここではレーザ・ダイオード12である光学送信器を制御するものであり、当該ダイオードの光線は、光学装置13によって対象7の当該表面に対して投影される。この事例では、その光度は、当該ジェネレータ11の当該変調信号によって変調される。それに従って反射され同様にして変調される当該光線は、カメラ光学機器14によって画像ピクセルの配列100に対して投影されるものであり、当該配列は、特には図8において示されたようなそれらのピクセル即ち光混合エレメントという形態を探ることが可能なものである。

【0044】

それらは、当該I出力に関する調節可能な時間遅延T₀及び当該Q出力に関する

る補足的な一定の時間遅延 $T_{\text{チャップ}}$ を備えて、当該ダイオード 1 2 と同じ当該 P N ジェネレータ 1 1 からの変調信号ではあるが、プッシュ・プル関係であるように成して、遅延部材 1 5 によって変調される。従って、変調して受信された当該光線信号は、その同じ変調関数を使用してそれらの変調フォト・ゲートによってピクセル毎に 2 回ずつ相関されるのであり、それは、遷移時間情報を必要とするものであり、従って、当該対象 7 の当該表面についての個々のエレメントの間隔情報をも必要とすることになる。

【0045】

長くて狭い各ストリップという形態を探る本発明に従った当該構成の場合には、深部情報に関するそれらの情報は、当該対象 7 の当該表面における明暗境界線の故に、もはや誤って解釈されることがないのである。

【0046】

図 1 1 及び図 1 2 は、位相調整回路 P L L 及び D L L による光学信号についての高感度な受信における対応する P M D エレメントの使用を示している。

【0047】

図 1 1 は、当該 P M D ピクセルは、光線バリア装置において有益に使用され得る非常に高いレベルの感度を有する電子光学的な混合エレメントとして、及び時間経過カメラ、光学的なリモート・コントロール装置及びデータ光線バリア・アセンブリにおける P L L 配列としてだけでなく、光学通信におけるデータ信号の当該再生のためのものとしても、P M D ピクセルを備えるように成した、光学的な P L L 回路又は D L L 回路を示している。光学的な P M D - P L L は、当該フォトダイオードの下流に接続される通常の受信 H F 増幅器として高度に集積され得るものであり、その電子的なミキサーは、完全に排除されることになる。何故なら、当該出力 3 4 において当該読出し回路 3 1 を備えた当該光混合デテクタ P M D は、低域フィルタ処理された差信号 U_A - 一定数 $\cdot (i_a - i_b)$ という形態を探って当該低周波領域における当該混合した成果を既に提供しているからである。当該位相調整回路は、ループ・フィルタ又はデジタル・レギュレータを介して接続される。

【0048】

それは、例えば正弦、直交、周波数、位相の変調のためのものとして、更には、例えばP N符号化であるコード・マルチプレックス処理のためのものとして、多くの変調モードに関連して使用されることが可能である。その場合、当該電圧制御式ジェネレータ33は、受信されることになる当該クロック速度及び変調に対して設定される。当該位相調整回路がラッチされるとき、本発明に従った広帯域PMDの当該事例では当該読み出し回路31の広帯域総和出力35において、或いはそれと同じ光学データ信号によって並列に操作される増幅器を備えた広帯域フォトダイオードを経由して生じるように成した、データ信号は、当該種類のクロック復元の故に入出力判定エレメント32によって再生されることが可能である。その理由のために、当該光学的な入出力データ信号は、好ましくは、ゼロ復帰(RZ)信号として符号化される。

【0049】

図12は、より高度なレベルの感度さえも、特にはP N変調に拠るものであるIQ-PMD受信器をベースとして達成され得るように成した、2Q-PMD-DLLを示している。

【0050】

本件特許出願の基礎を形成するように成した、同じ出願人に関するものである上述の当該特許出願における場合と同様に、周期的なP N変調は、PMD受信に関連して大きな利点を提供するものであり、特にはマルチ・チャネル選択性の可能性、マルチ・ターゲット検出、及び位相遷移時間解像度に関する最高の感度を提供するのである。本発明に拠れば、P N符号化されたデータ信号を、間隔計測を包含するデータ光線バリア装置のためのものとして、更には例えば図12において示されるような光学的なCDMAデータ送信のためのものとして使用することもまた実行可能である。それに関連して、例えば論理「1」は、通常のP Nワードに対応するものであるが、論理「0」は、逆転したP Nワード=P Nに対応するものであり、即ち、それらの明暗チップが交換されるのである。図11に対比して、図12において、それらの光電流の量的な差違に関する差として形成されるものは： $U_d = \text{定数} \cdot (|i_a - i_b| - |i_c - i_d|)$ である。当該復元されたワード・クロックに拠れば、当該P N符号化された入出力データ・シ

一ケンスの当該データ信号を所定の手順によって再生することが実行可能であり、その結果、当該総和器の中において、それらの光電流の量的な差違の総和：

$U_z = \text{定数} \cdot (|i_a - i_b| - |i_c - i_d|)$ が、当該総和器の中に包含された短期インテグレータによって、PNワード長さのためのものとしてそれぞれに形成され、当該入出力判定エレメントの中では、当該入出力判定が、後続の評価又は再生のためのものとしてクロック同期的な様式で選択されるのである。

【0051】

当該変調電圧のための正弦変調を備えて、当該正弦周期の $T_{\text{チャップ}} = T/4$ をも備えるように成したVCOを使用すれば、ベクトル変調を検出して再生することもまた実行可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施例のピクセルに関する平面図である。

【図2】

2つの隣接するピクセルの相互接続を示している。

【図3】

図2の線III-IIIに沿って採られた断面において、図2で示されたそれらのピクセル・エレメントを介する断面図の一部を示している。

【図4】

図2で示されたダブル・ピクセル即ち2象限ピクセルの一部を拡大して示す平面図である。

【図5】

それぞれの事例において、2つのそれぞれの累算ゲートと埋設n層との間における3つの変調フォト・ゲートを備えるように成し、当該絶縁材料の中に変調フォト・ゲート電極が埋設されるように成した、本発明のもう1つの実施例のピクセルを介して当該ストリップ方向に直行する断面の図面である。

【図6】

図4に対応して図5で示されたマルチ・ストリップ技術における当該PMDピクセルの3ゲート構造に関する平面図である。

【図7】

図5および図6で示された当該ピクセルの一部の斜視図である。

【図8】

異なったストリップ方向付けによって互いに接続され、様々な操作モードのためのピクセル・ユニットを形成するように成した、4個のピクセル・エレメントを示している。

【図9】

図8で示されたような 2×4 個のピクセルから構成されるフィールドを示している。

【図10】

図9に類似した比較的大きなフィールドから構築される3Dカメラの操作モードを概略的に示している。

【図11】

光線バリア、時間経過カメラ即ち遅延カメラ、及び光学データ信号再生を備えたデータ光線バリアのためのものである光学的PLL回路又はPMDベースのDL回路を示している。

【図12】

特には、高感度データ光線バリア、位相遷移時間計測、好ましくは光学CDMA（コード分割多重アクセス）システムにおける光学データ転送のためのものであり、更には光学データ信号再生をも備えるように成した、バンド・スプレッド技術によって同相信号及び矩形信号を計測するためのログイン増幅回路を示している。

【図1】

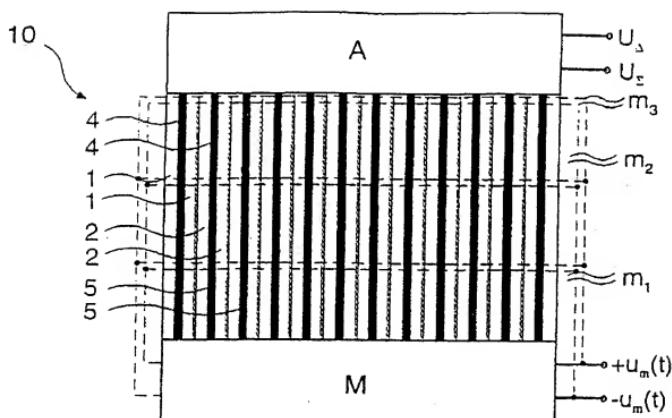


Fig. 1

【図2】

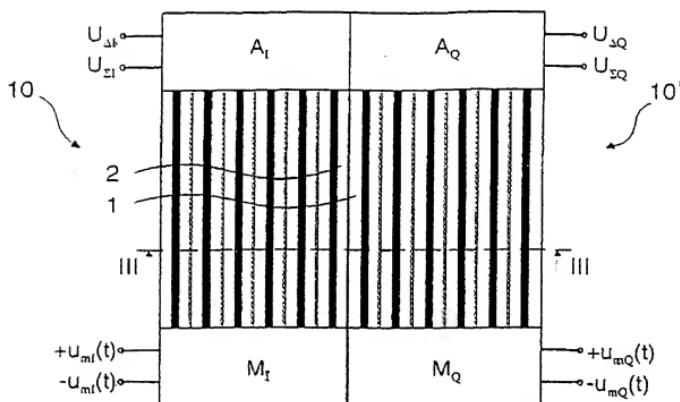
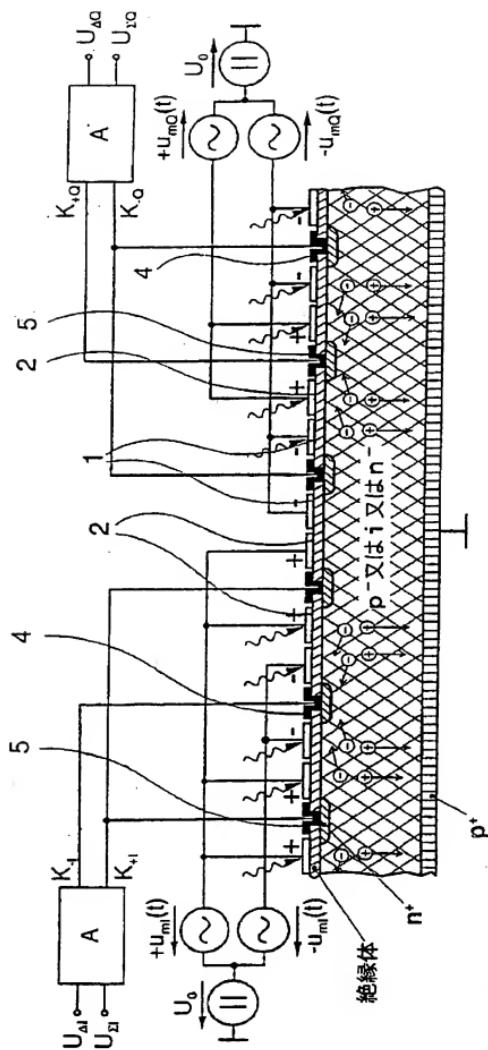


Fig. 2

【図3】



【図4】

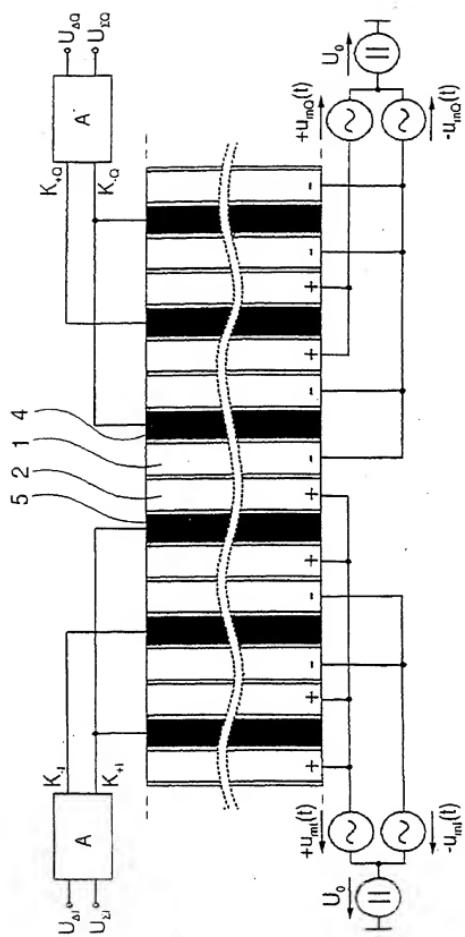
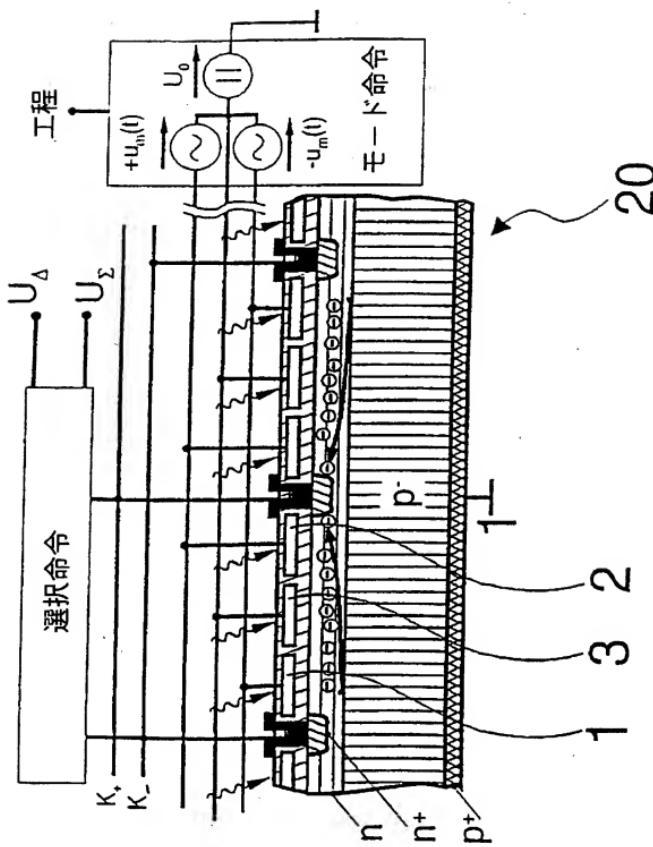
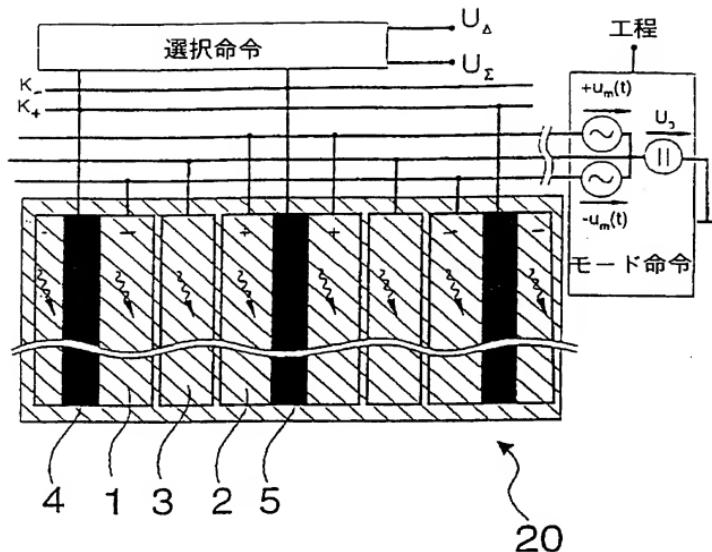


Fig. 4

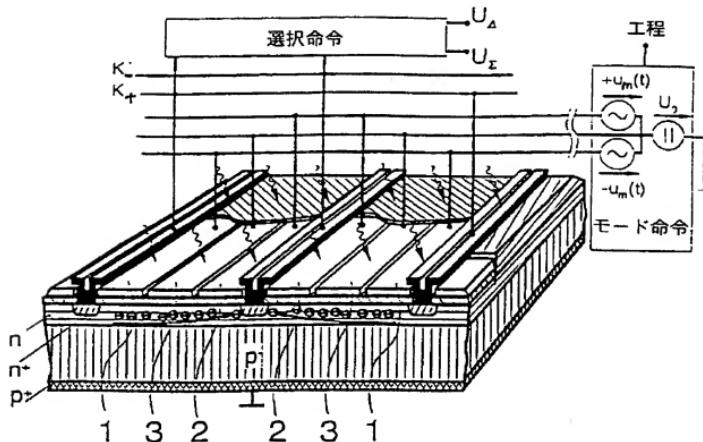
【図5】



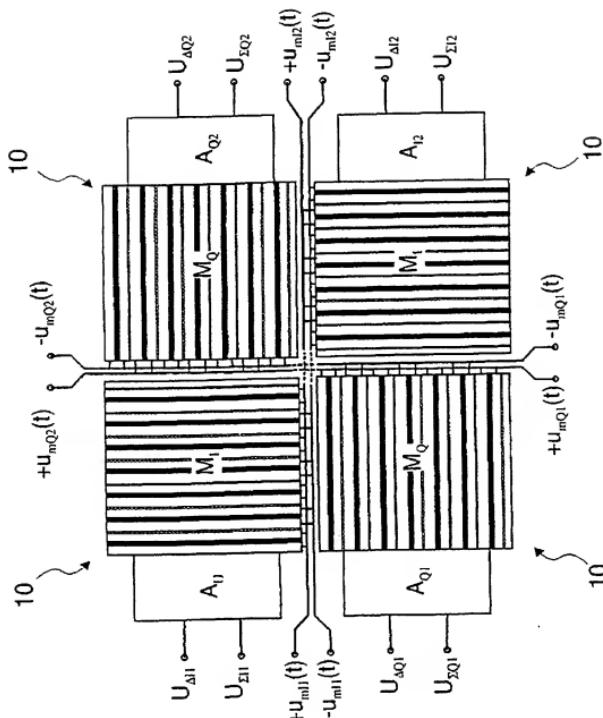
【図6】



【図7】



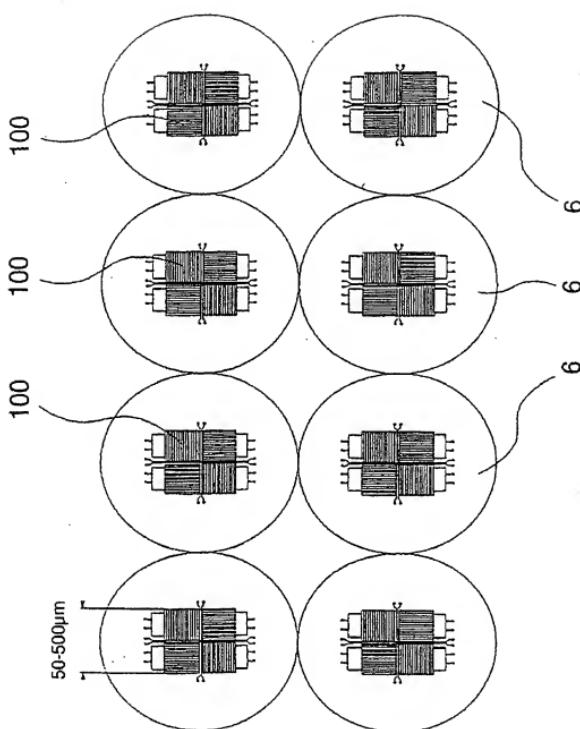
【図8】



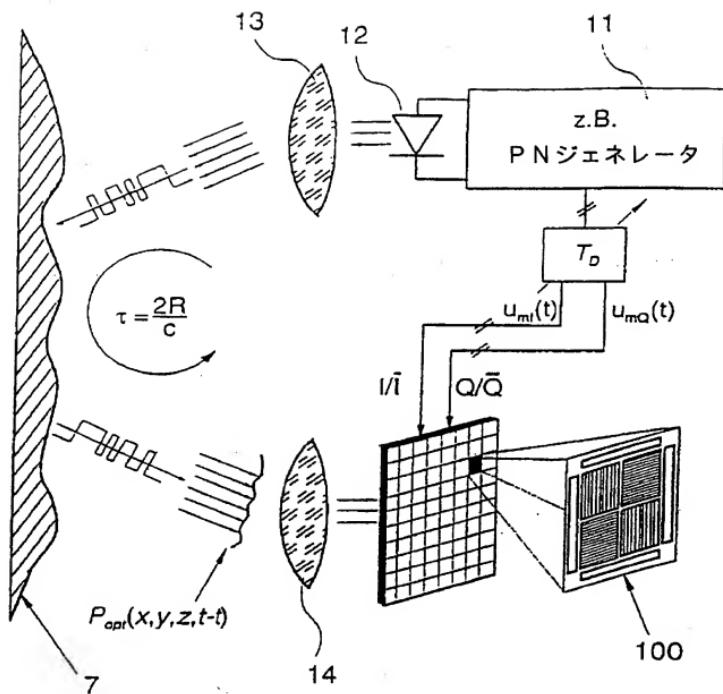
8

【図9】

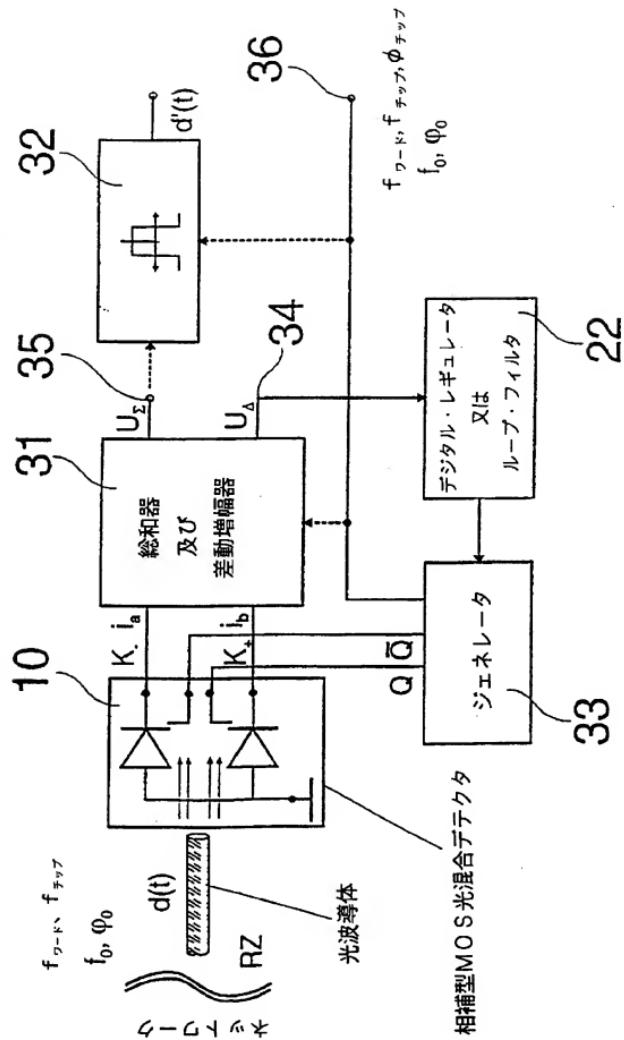
Fig. 9



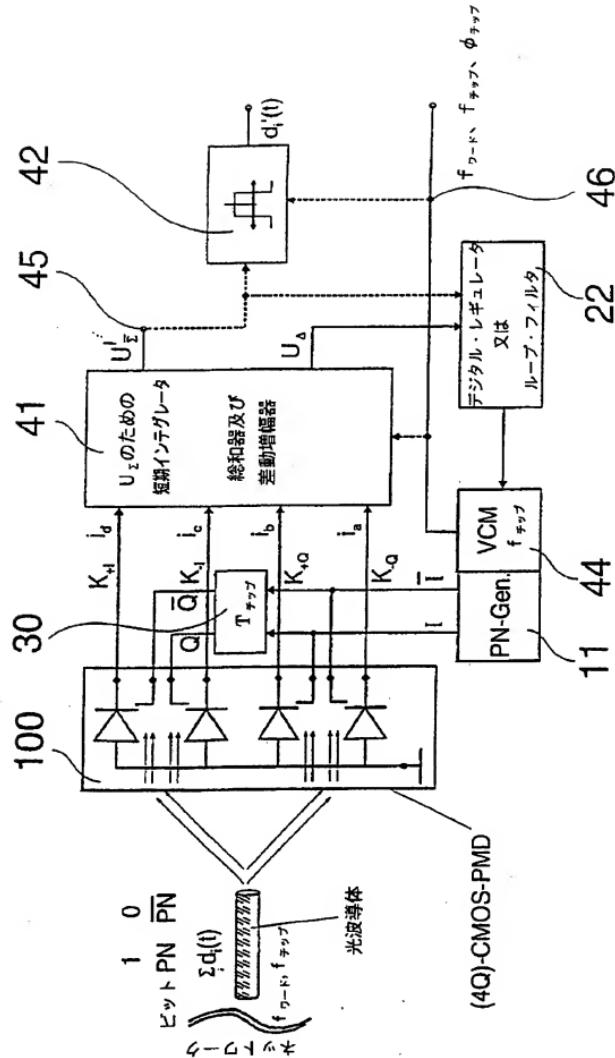
【図10】



【図 1 1】



【☒ 1 2】



【国际調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

		International Application No. PCT/DE 99/01436												
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 H01L27/146														
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC														
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 H01L GO15 G01B														
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched														
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)														
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Category *</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">DE 197 04 96 A (SCHWARTE RUDOLF PROF DR ING) 12 March 1998 (1998-03-12) cited in the application page 2, line 3 -page 5, line 14 page 5, line 57 -page 6, line 15 page 7, line 44 -page 10, line 15</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1-23</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">SPIRIG T ET AL: "THE LOCK-IN CCD - TWO-DIMENSIONAL SYNCHRONOUS DETECTION OF LIGHT" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, vol. 31, no. 9, 1 September 1995 (1995-09-01), pages 1705-1708, XP000526180 ISSN: 0018-9197</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">22,23</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">---</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">---</td> </tr> </tbody> </table>			Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	A	DE 197 04 96 A (SCHWARTE RUDOLF PROF DR ING) 12 March 1998 (1998-03-12) cited in the application page 2, line 3 -page 5, line 14 page 5, line 57 -page 6, line 15 page 7, line 44 -page 10, line 15	1-23	A	SPIRIG T ET AL: "THE LOCK-IN CCD - TWO-DIMENSIONAL SYNCHRONOUS DETECTION OF LIGHT" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, vol. 31, no. 9, 1 September 1995 (1995-09-01), pages 1705-1708, XP000526180 ISSN: 0018-9197	22,23		---	---
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.												
A	DE 197 04 96 A (SCHWARTE RUDOLF PROF DR ING) 12 March 1998 (1998-03-12) cited in the application page 2, line 3 -page 5, line 14 page 5, line 57 -page 6, line 15 page 7, line 44 -page 10, line 15	1-23												
A	SPIRIG T ET AL: "THE LOCK-IN CCD - TWO-DIMENSIONAL SYNCHRONOUS DETECTION OF LIGHT" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, vol. 31, no. 9, 1 September 1995 (1995-09-01), pages 1705-1708, XP000526180 ISSN: 0018-9197	22,23												
	---	---												
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.		<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.												
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "B" document not published on or after the international filing date "C" document which may prove useful on priority claim(s) or which may be used to support the publication date of another document or other special reasons (see below) "D" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "E" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed														
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report												
21 October 1999		29/10/1999												
Name and mailing address of the ISA		Authorized officer												
European Patent Office, P.B. 5810 Palaisstr. 2 D-8036 Munich 2 Tel. (+49-70) 340-3040, Tx. 31 851 apn. 91 Fax: (+49-70) 340-3016		Jacquin, J												

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l. Patent Application No.
PC./DE 99/01436

C (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 826 312 A (LAMBETH DAVID N) 2 May 1989 (1989-05-02) column 3, line 34 - line 57 -----	1

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 99/01436

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE 19704496 A	12-03-1998	AU WO	4376197 A 9810255 A	26-03-1998 12-03-1998
US 4826312 A	02-05-1989	EP JP WO	0245448 A 63501395 T 8703140 A	19-11-1987 26-05-1988 21-05-1987

フロントページの続き

(81)指定国 E P (A T, B E, C H, C Y,
D E, D K, E S, F I, F R, G B, G R, I E, I
T, L U, M C, N L, P T, S E), O A (B F, B J
, C F, C G, C I, C M, G A, G N, G W, M L,
M R, N E, S N, T D, T G), A P (G H, G M, K
E, L S, M W, S D, S L, S Z, U G, Z W), E
A (A M, A Z, B Y, K G, K Z, M D, R U, T J
, T M), A L, A M, A T, A U, A Z, B A, B B
, B G, B R, B Y, C A, C N, C U, C Z, D K,
E E, E S, F I, G B, G E, G H, G M, H R, H
U, I D, I L, I N, I S, J P, K E, K G, K P
, K R, K Z, L C, L K, L R, L S, L T, L U,
L V, M D, M G, M K, M N, M W, M X, N O, N
Z, P L, P T, R O, R U, S D, S E, S G, S I
, S K, S L, T J, T M, T R, T T, U A, U G,
U S, U Z, V N, Y U, Z A, Z W

(51)Int.Cl.⁷
G 0 1 J 9/00
/ G 0 1 S 7/48
G 0 2 F 1/01

識別記号

F I
G 0 1 J 9/00
G 0 1 S 7/48
G 0 2 F 1/01

マークコード (参考)
Z
D

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 56 頁)

(21)出願番号 特願平10-512124
(22)出願日 平成9年9月5日 (1997.9.5)
(85)翻訳文提出日 平成11年3月4日 (1999.3.4)
(86)国際出願番号 PCT/DE97/01956
(87)国際公開番号 WO98/10255
(87)国際公開日 平成10年3月12日 (1998.3.12)
(31)優先権主張番号 19635932.5
(32)優先日 平成8年9月5日 (1996.9.5)
(33)優先権主張国 ドイツ (D E)
(31)優先権主張番号 19704496.4
(32)優先日 平成9年2月7日 (1997.2.7)
(33)優先権主張国 ドイツ (D E)

(71)出願人 シュヴァルト ルドルフ
ドイツ国 ネッフェン ディー-57250 ク
ラウツティラー シュトラーサ 56
(72)発明者 シュヴァルト ルドルフ
ドイツ国 ネッフェン ディー-57250 ク
ラウツティラー シュトラーサ 56
(74)代理人 弁理士 重信 和男 (外1名)

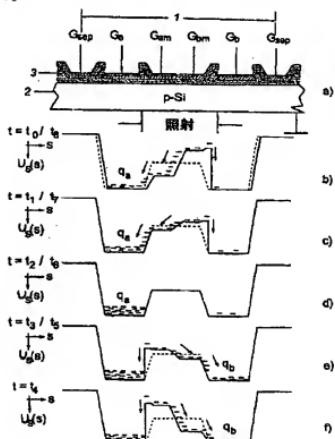
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁場の位相情報および/または振幅情報を調べるための方法と装置

(57)【要約】

本発明は、電磁波の位相および/または振幅情報を調べる方法と、その装置に関するものである。かかる方法で得られた画像データの空間深さ分解能を提供するために、本発明による方法は以下の段階を含む：少なくとも2つの光変調光ゲート G_{sa} と G_{sb} および関連蓄積ゲート G_a と G_b を有する少なくとも1つの画素を含む光混合素子の表面に電磁波が照射され、 $U_{sa} = U_0 + U_a$ (t) および $U_{sb} = U_0 - U_a$ (t) として構成されている変調光ゲート電圧 U_{sa} (t) および U_{sb} (t) が、変調光ゲート G_{sa} および G_{sb} に印加される段階； U_0 および変調電圧 U_a (t) の振幅以上の大きさを持った直流電圧が、蓄積ゲート G_a および G_b に印加される段階；入射電磁波によって変調光ゲート G_{sa} および G_{sb} の空間電荷領域に生じた電荷キャリアが、変調光ゲート電圧 U_{sa} (t) と U_{sb} (t) の極性の関数として、ドリフト電界の電位勾配および対応蓄積ゲート G_a または G_b へのドリフトを受けさせられる段階；蓄積ゲート G_a および G_b にドリフトされた電荷 q_a と q_b がそれぞれ転送 (driven) される段階。当該光混合素子は、少なくとも1つ

【図1】



【特許請求の範囲】

1. 電磁波の位相および／または振幅情報を決定する方法において、
 - 電磁波を少なくとも1つの画素を有する光混合素子の表面に照射し、上記の画素は少なくとも2つの感光変調光ゲート G_{aa} と G_{bb} および関連する蓄積ゲート G_a と G_b を有し、
 - 上記の変調光ゲート G_{aa} と G_{bb} に U_{aa} (t) = $U_a + U_b$ (t) および U_{bb} (t) = $U_a - U_b$ (t) の形式の変調光ゲート電圧 U_{aa} (t) と U_{bb} (t) を加え、
 - 上記の蓄積ゲート G_a と G_b に大きさが U_a の合計と少なくとも同じ大きさのdc電圧と変調電圧 U_a (t) の振幅を印加し、
 - 入射電磁波によって変調光ゲート G_{aa} と G_{bb} の空間電荷領域に生成された電荷キャリアを変調光ゲート電圧 U_{aa} (t) と U_{bb} (t) の極性および上記の対応する蓄積ゲート G_a と G_b に対するドリフトに応じてドリフト電界のポテンシャルグラディエントに照射し、
 - それぞれの蓄積ゲート G_a と G_b にドリフトした上記の電荷 q_a と q_b を取り去ることを特徴とする方法。

電荷 q_{a1} と q_{b1} 並びに q_{a2} と q_{b2} を取り去り電荷の差分 $(q_{a1} - q_{b1})$ と $(q_{a2} - q_{b2})$ を形成し、

一下記等式

$$\varphi_{opt} = \frac{q_{a2} - q_{b2}}{q_{a1} - q_{b1}}$$

に従って上記の入射電磁波の画素の位相 ψ_{opt} を送信器の照射した上記の電磁波の位相に対して決定し、従って上記の画素の受け取った電磁波のトランジット時間を決定することを特徴とする請求の範囲第2項記載の方法。

4. - 4つの変調光ゲート G_{aa} 、 G_{ba} 、 G_{ca} と G_{da} および4つの関連する蓄積ゲート G_a 、 G_b 、 G_c と G_d によって、送信器の照射した上記の電磁波の位相に対する変調光ゲート電圧 U_{aa} (t) = $U_a + U_{a1}$ (t) と U_{ba} (t) = $U_b - U_{a1}$ (t) と U_{ca} (t) = $U_c + U_{a2}$ (t) と U_{da} (t) = $U_d - U_{a2}$ (t) の2つの異なる位相シフト Δ_{a1} と Δ_{a2} について、同時に電荷 q_a 、 q_b 、 q_c と q_d を分離して取り去り、

一下記等式

$$\varphi_{opt} = \frac{q_c - q_d}{q_a - q_b}$$

に従って、上記の送信器の照射した上記の電磁波の画素の位相 ψ_{opt} およびこれと共に上記のピクセルの受け取った電磁波のトランジット時間を決定することを特徴とする請求の範囲第3項記載の方法。

5. - 上記の光混合素子は複数の画素を有し、
 - 少なくとも1つの画素が、上記の送信器からの上記の強度変調電磁波の一部と共に直接照射され、
 - 上記の照射した電磁波と上記の変調光ゲート電圧 U_{aa} (t) と U_{ba} (t)

との間の位相シフトの校正を上記の画素によって測定した上記の位相シフトから実行することを特徴とする先行する請求の範囲の1つに記載の方法。

6. - 独立して励起された未知の強度変調を有する電磁波を上記の光混合素子の表面に照射し、
 - 上記の変調光ゲート電圧 U_{aa} (t) と U_{ba} (t) を同調可能変調用発振器によって生成し、

—上記の生成した電荷キャリアを上記のプッシュプル変調光ゲート電圧 $U_{\text{as}} (t)$ と $U_{\text{bs}} (t)$ の位相に応じてドリフト電界のポテンシャルグラディエントに更に照射し、

—上記の光混合素子と上記の変調用発振器は少なくとも 1 つの位相ロックループを形成し、上記の電磁波をロックイン法に従って測定することを特徴とする請求の範囲第 1 項記載の方法。

7. 連続または非連続 H F 変調疑似ノイズ変調またはチャーブ変調を周期的変調として使用することを特徴とする請求の範囲第 1 項ないし第 6 項の 1 つに記載の方法。

8. 上記の変調は H F 変調であり、好ましくは、移動シフト $\Delta\phi = 0^\circ / 180^\circ$ と $90^\circ / 270^\circ$ に対する上記の電荷 q_a と q_b および場合によっては q_a と q_d を取り去ることを特徴とする請求の範囲第 7 項記載の方法。

9. 定常状態変調を変調光ゲート電圧 $U_{\text{as}} = U_a + U_{\text{m}}$ および $U_{\text{bs}} = U_b - U_{\text{m}}$ と共に使用し、設定可能変調 d_c 電圧 U_{m} は時間に対して一定であり、上記の変調 d_c 電圧によってジオ電荷 q_a と q_b との差から得られる差分画像を具体的にウエイト付けすることを特徴とする請求の範囲第 1 項記載の方法。

10. 上記の蓄積ゲート G_a と G_b の下方の電荷 q_a と q_b を集積し、多重構造、

好ましくは C C D 構造によって読み出すことを特徴とする請求の範囲第 1 項ないし第 9 項の 1 つに記載の方法。

11. 上記の蓄積ゲート G_a と G_b は p n ダイオードの形態であり、好ましくはブロック低容量 p n ダイオードであって好ましくは C M O S 技術を使用し、上記の電荷 q_a と q_b および場合によっては q_a と q_d を電圧または電流として直接読み出すことを特徴とする請求の範囲第 1 項ないし第 9 項の 1 つに記載の方法。

12. 上記の画素位相または画素トランシット時間および画素輝度は、アクティブ画素センサ構造 (A P S) によって直接確認し、好ましくはワンチップ多重構造によって選択的および／または連続的に読み出すことを特徴とする請求の範囲第 11 項記載の方法。

13. 上記の画素輝度は、濃淡画像としての上記の関連蓄積ゲートの電荷の合

計としてそれぞれ評価することを特徴とする請求の範囲第1項ないし第12項記載の方法。

14. 背景照明または外部からの非変調追加照明の場合、上記の濃淡画像の差分を一方では上記の変調照明がオンになり他方では上記の変調照明がオフになる場合、補正パラメータとして使用することを特徴とする請求の範囲第1項ないし第13項記載の方法。

15. 複数の独立した混合素子を線、面または空間アレイに使用することを特徴とする請求の範囲第1項ないし第14項の1つに記載の方法。

16. 上記の画素の内の少なくとも1つを照明として機能する上記の強度変調電磁波の一部と共に直接照射し、上記の少なくとも1つの画素における測定を使用して上記のその他の位相と輝度の結果を校正し、異なったレベルの強度または

異なった値に設定することのできる強度のレベルを有する送信器によって好ましくは1個または複数個の基準画素を作用させることを特徴とする請求の範囲第15項記載の方法。

17. 一少なくとも1つの画素(1)、
一少なくとも2つの感光変調光ゲート(G_{aa} 、 G_{bb})、および
一上記の変調光ゲート(G_{aa} 、 G_{bb})と関連し、入射電磁波に対して遮蔽される蓄積ゲート(G_a 、 G_b)を具備することを特徴とする光混合素子。

18. 中間ゲート(G_o)を上記の変調光ゲート(G_{aa} 、 G_{bb})の間に構成することを特徴とする請求の範囲第17項記載の混合素子。

19. 上記の素子(1)は、4個の好ましくは対照的に構成された変調光ゲート(G_{aa} 、 G_{bb} 、 G_{ca} 、 G_{da})と蓄積ゲート(G_a 、 G_b 、 G_c 、 G_d)を有することを特徴とする請求の範囲第17項または第18項記載の混合素子。

20. 上記の蓄積ゲート(G_a 、 G_b および G_c 、 G_d)は、p nダイオードの形態であり、好ましくはブロック低容量p nダイオードであって好ましくはCMOS技術のダイオードであり、電荷 q_a と q_b および場合によっては q_c と q_d を電圧または電流として直接読み出すことができることを特徴とする請求の範囲第17項ないし第19項の1つに記載の混合素子。

21. 最大変調速度を増加するため、上記の画素は、G a A s 技術を使用して生成し、好ましくは「埋込みチャンネル」型（例えば埋込みnチャンネル）であり、集積ドリフト電界を有することを特徴とする請求の範囲第17項ないし第20項記載の混合素子。

22. 上記の素子（1）は、一部には画素関連信号処理を有し、一部にはラインまたは場合によってはマトリックス関連信号処理を有するアクティブ画素センサ構造の形態であることを特徴とする請求の範囲第17項ないし第21項記載の混合素子。

23. 上記の遮蔽部は、上記の変調光ゲートの縁部領域までまた延びていることを特徴とする請求の範囲第17項ないし第22項記載の混合素子。

24. 上記の光混合素子が1次元、2次元、または3次元に構成されていることを特徴とする装置に関する請求の範囲第17項ないし第23項の1つに記載の少なくとも2つの光混合素子を有する混合素子構成。

25. 2つの隣接して構成された異なる画素（n、n+1）とそれぞれ関連する変調光ゲート（G_{an}、n、G_{an}、n+1）と（G_{bn}、n、G_{bn}、n+1）はそれぞれ共通の蓄積ゲート（G_s）を有し、上記の変調光ゲート（G_{an}、n、G_{an}、n+1）と（G_{bn}、n、G_{bn}、n+1）は同一の変調光ゲート電圧U_{an}（t）とU_{bn}（t）によってそれぞれ動作されることを特徴とする請求の範囲第24項記載の混合素子構成。

26. 基準画素としての少なくとも1つの画素（1）の直接照射用にデバイスを設け、これによって送信器から照射した強度変調電磁照射の一部を問題の1個または複数個の画素に向けることを特徴とする請求の範囲第24項または第25項記載の混合素子構成。

27. 上記の直接照射用のデバイスは、上記の照射の強度の空間および／または時間に関する変動のために設けられることを特徴とする請求の範囲第26項記載の混合素子構成。

28. 上記の画素（1）はシリコン基板（2）上にMOS技術を使用して実施され、多重構造、好ましくはC C D構造によって読み出すことができる特

徴とする請求の範囲第24項ないし第27項の1つに記載の1次元または多次元混合素子構成。

29. マイクロレンズ光システムを設け、上記のマイクロレンズ光システムは画像の記録に使用する各混合素子用に対してそれ自身のマイクロレンズを実質的に生成し、上記のマイクロレンズによって入射照射は上記の混合素子の中央領域に合焦し、これによって上記の混合素子のサイズを小さくすることができることを特徴とする請求の範囲第24項ないし第28項の1つに記載の混合素子構成。

30. 一装置に関する請求の範囲第17項ないし第23項の1つに記載の少なくとも1つの光混合素子を有し、

一変調用発振器(10、13)を有し、

一照射した電磁波が所定の方法で上記の変調用発振器(10、13)によって強度変調される送信器(4)を有し、

一物体(6)から反射した上記の電磁波は上記の光混合素子の面上に照射され

一上記の変調用発振器(10、13)は上記の光混合素子に上記の送信器から照射した電磁波の位相に対して所定の位相関係にある変調電圧 $U_a(t)$ を供給することを特徴とする電磁波位相情報決定装置。

31. 請求の範囲第24項ないし第29項の1つに場合によって記載の光システム(7)と混合素子構成を設け、上記の光システム(7)は上記の反射した電磁波の画像を上記の混合素子または上記の混合素子構成上に形成することを特徴とする先行する装置に関する請求の範囲に記載の装置。

32. 関連光受信システム、差異信号、合計信号および関連基準信号用の電子的評価および信号処理システム、濃淡画像およびトランシット時間または距離画像用デジタルメモリ、変調電磁波によって3次元シーンを照明する送信器、および上記の光受信システムに対応し、コンパクトユニットの形態でデジタル3D写

真用カメラを形成する調整可能光送信システムを光混合素子に設けることを特徴とする請求の範囲第30項または第31項記載の装置。

33. デジタル3次元記録用ビデオカメラを形成するため、関連光受信システ

ム、差異信号、合計信号および関連基準信号用の電子的評価および信号処理システム、濃淡画像およびトランシット時間または距離画像用デジタルメモリ、変調電磁波によって3次元シーンを照明する送信器、および上記の光受信システムに対応する調整可能光送信システムを光混合素子構成に設け、更にデジタル画像シーケンスを格納するメモリ手段を設けることを特徴とする請求の範囲第30項または第31項記載の装置。

34. 上記の送信器には種々のスペクトル領域の光波を照射するデバイスを設け、カラー画像またはカラー画像成分を生成することを特徴とする請求の範囲第32項または第33項記載の装置。

【発明の詳細な説明】

電磁波の位相情報および／または振幅情報を調べるための方法と装置

本発明は、電磁波の位相情報および振幅情報を調べる方法と装置に関する。

本明細書中、位相という言葉は、位相トランシット時間および関係各信号形状に基づいて使用されもする特定のトランシット時間を表す。

以下、電磁波ではなく光波について言及する。但し、これは、可視電磁波のスペクトル領域のみに対する限定を意味するものではなく、単に簡素化することを目的としている。

電子測定技術および通信技術で、広帯域、高周波数の信号の振幅と位相の点から周波数成分を測定する場合、未知の信号を正弦振動に掛けるまたは正弦振動と混合し、統合またはローパスフィルタリング処理によって同一周波数の信号成分が存在する状態で生じる一定成分を測定する位相検出器を利用することが多い。

この方法により、任意の調整可能な相対位相位置の混合信号を利用して、未知の信号の相関関数が得られる。混合周波数を変える（掃引する）ことにより、未知の信号をそのスペクトル成分に分解できる。また、少なくとも3つの位相位置により、同周波数の未知の周波数成分の振幅と位相が変わる安定成分を求めることができる。

今日、測定および通信技術分野で重要性を増しつつある当該光信号の研究は、特に電気信号について先述した電子測定値後確認のある光電変換器としての広帯域光検出器によって実施されている。

関連経費の高額さ故、これらの方法および関係測定装置は、通常、1チャネルまたは2チャネルのタイプのものだけである。しかしながら、光信号の場合は、高周波成分を備えた（特定の画像系列全体の）非常に多くの並列チャネルを同時に測定しなくてはならないことが多い。

また、2次元光波のスペクトル変調特性の他に关心を集めているのは、所定の空間および時間範囲内の高速動作である。更に、例えば光レーダー法によって、

3次元オブジェクトを迅速かつ正確に測定したいという要望があるが、それには光速のエコー信号の結果としてサブナノ秒範囲の超高速な検出器が必要である。

同時に、能動的または受動的に明るい3次元オブジェクトを走査するという面倒な操作を無くすことが望まれている場合、前述の検出器は検出器アレイとしても利用できなくてはならない。

そのような3Dカメラは、ドイツ特許出願公開明細書第44 39 298号に提案されており、本発明はその内容を基本出発点に採用している。

図10は、エコートランシット時間または位相トランシット時間のプロセスを基礎とする3Dカメラを示すものである。変調光送信器107と103によって照射され、3次元オブジェクト100から反射されるHF変調光波101は、同位相面の遅延の深さ情報をすべてを含んでいる。入射光波が、ホモダイソミキシングまたは復調プロセスに対応する同一周波数の2次元光ミキサ104によつて受信開口102内で再び変調される場合、安定した高周波インターフェログラムが得られる。

このHFインターフェログラムは、従来のCCDカメラ104で記録することができ、また、画像処理装置106を使って更なる処理を施すことが可能である。CCD光電量(photoelectric charge)の混合生成物の定常成分の統合は、2つのミキシング信号の相関関数の構成に対応している。エコートランシット時間および振幅による距離関連の位相遅延は、例えば、0°と10°と240°、または、0°と90°と180°と270°など、復調ミキシング周波数の種々の位相により、3つ以上のインターフェログラムから画素的に計算できる。

光空間変調器またはSLMとも呼ばれる2次元光ミキサ103または104は、この場合、例えば、ポッケルス(Pockels)セルを有しているが、このポッケルスセルは資料に一連の重大な欠点が記載されている。

前述以外の実行オプションはLCDウインドウによって提供されが、これらは明らかに安価であるものの、所望帯域幅の観点から見ると約1000分の1ほど低すぎる。

像増幅器に使用されている、いわゆるマイクロチャネルプレートの利用も高価で費用がかかる。マイクロチャネルに印加されてマイクロチャネル内の2次電子

放出に影響を及ぼす加速電圧を変調することによって利得を変調できる。

また、最先端技術で、CCD光検出器アレイを基礎とする2次元相関器が提案されている: 「The Lock-In CCD-Two-Dimensional Synchronous Detection of Light」スピリグ(S p i r i g)、セイツ(S e i t z)他著、IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 31, No. 9, pp. 1705-1708, 1995年9月。該文献中、正弦変調光の位相を確認するために、光画素(p h o t o p i x e l)が4つのトランスマルチゲートによって識別される。各正弦周期ごとに、4つのトランスマルチゲートによりそれぞれの等距離サンプルが取られ、それによって簡単に位相を計算できる。最初に、帯域幅を著しく制限した走査時間内で高調光信号の統合が行われるために、前述手順は指摘した課題にあっては遅すぎる。また、その後でなければ、走査サンプルとして引き継いだ蓄積電荷を利用する所望のミキシング処理を実施できない。

そこで、本発明の目的は、位相および／または振幅情報、および光波の包絡線を調べるための方法と装置であって、よりシンプルで、より帯域幅が広く、より安価な相関器の概念と、設定可能照明による3次元オブジェクトの高速測定を可能とする方法と装置を提供することである。

前述の目的は、請求の範囲1記載の方法、請求の範囲14記載の光混合素子(ph otonic m i x i n g e l e m e n t)、請求の範囲20記載の光混合素子配列、および請求の範囲23記載の装置によって達成される。

本発明による原理は、変調光ゲート電圧と、隣接する少なくとも2つの感光変調光ゲートの下の材料の光波によって光発生する少数電荷キャリアの分離とによってもたらされるドリフトを基礎とするものである。この場合、それぞれの関連極性または位相に応じて変調光ゲートに印加される変調光ゲート電圧 $U_{a\alpha}(t)$ と $U_{b\alpha}(t)$ の影響を受けて、前述の電荷キャリアが、好ましくはd c電圧 $U_{a\alpha}$ と $U_{b\alpha}$ の2倍でバイアスをかけられた蓄積ゲートにドリフトされる。変調光ゲートの電圧 $U_{a\alpha}(t)$ と $U_{b\alpha}(t)$ は補足的に印加されることが好ましく、また、

バイアス電圧およびそれぞれブッシュプル関係に重畠される変調電圧 $+U_{\alpha}(t)$ と $-U_{\alpha}(t)$ から構成されることが好ましい。2つの変調光ゲートは一緒に

矩形面を形成することが好ましい。2つの変調光ゲートのみを備えている画素は、2重画素と呼ぶこともできる。

本発明による原理は、電磁波によって生じる光電量子効果を前提とするものである。それにも関わらず、光波に対する照会が常に行われるが、これは制限と解釈されるものではない。

実際のミキシングすなわち乗算処理は、変調光ゲートの右側または左側への、光発生電荷キャリアの変調電圧依存または位相依存ドリフト（「チャージスイング（charge swinging）」）にある。これに関し、前述のように分離されて蓄積ゲートに集められ、所定時間内の蓄積に関係ある電子読み出しシステムに伝達される電荷キャリア間の荷電差は、変調入射光信号の包絡線と変調電圧 $U_a(t)$ との相関関数に関する測定値である。

同時に、蓄積ゲートにドリフトされて通過する前述の電荷キャリアの電荷合計は、チャージスイングの位置による影響を受けない状態にあり、最適な画素強度または画素濃淡値として利用できる。

入射光波の相対位相または時間遅延を求めるには、前述のように、交流電圧成分、直流電圧成分、および相対位相の3つのパラメータについて3種類の測定を行う必要がある。従って、電送器の放射光波に対する3種類の位相ずれを備えた変調光ゲート電圧によって作動される3つの感光変調光ゲートを持った光混合素子画素構成を含むことが可能である。

しかしながら、結果として得られる相関振幅から、光混合素子の各画素の受信信号の位相を求めることが望ましい場合、ミキサ信号の異なる4つの位相に関する4種類の測定を利用する。これにより、ノイズを大幅に低減できる重複決定（over-determination）が提供される。

1画素あたり2つの変調光ゲートの変調光ゲート電圧をプッシュプル構成することにより、前述の測定の各2種類を同時に実施できる。したがって、例えばHF変調の場合、異なる4つの必要測定値を得るには、それぞれ放射光の位相に対

し、変調光ゲート電圧 $U_{a1}(t)$ と $U_{a2}(t)$ について $0^\circ / 180^\circ$ および $90^\circ / 270^\circ$ の位相差で、それぞれ 90° ずらして2種類の測定を行うだけ

十分である。

したがって、特に好ましい構成は、それぞれ1つの画素を形成する光混合素子が、対称に配置された4つの変調光ゲートを有し、それぞれ相互に対向するよう配置した各2つの変調光ゲートがプッシュプルまたは180°位相シフト変調光ゲート電圧に応じて作用し、この場合、2重画素に関連させて先に述べた、変調光ゲート電圧の0°／180°および90°／270°の位相差で其々90°ずらされた2種類の測定が同時に実施される構成である。このような画素を4重画素と呼ぶこともできる。

また、変調光ゲート電圧 $U_m(t)$ と $U_m(t)$ の位相シフトの較正の場合、送信器によって照射される光波の一部が、基準として、複数の光混合素子の配列から成る複数の画素のうちの少なくとも1つに向けられることが可能であることが好ましい。そして、この直接照射画素から得られる位相および振幅の情報は、較正操作に利用できるとともに、位相シフトを所定値に調整するのに利用することもできる。

逆に、能動オブジェクトが放射する入射光波の、個別励起される未知の変調の場合、少なくとも1つの光混合素子によって、ロックイン増幅器の既知の高レベル分解能で光波を測定できる。この目的のため、光混合素子は、送信器に代わる同調可能な変調用発振器(tunable modulation generator)とともに、位相ロックループを形成する。また、ロックイン増幅で、例えばHF変調のために位相ロックループが使用され、デジタル変調のために遅延ロックループが利用される。

受動物体を調べる場合、種々の方法によって照射光の変調および変調光ゲート電圧 $U_m(t)$ と $U_m(t)$ の対応変調を行うことができる。まず、連続HF変調を生じさせることができる。その場合、荷電差および電荷合計は、画素強度による影響を遡及的に受ける可能性のある間隔で繰り返し読み出され、光波の位相および振幅情報の評価が行われる。

例えば、各ケースで干渉背景照明を簡単に上回るために、有利な手順は、パルス形HF変調と照明による間欠モード動作である。その場合、光発生電荷は、

高周波パルスのときにそれぞれ集積されて、後で評価される。

特に反射光波の位相またはトランシット時間を調べる場合、位相またはトランシット時間の分解能のレベルを増大するために、例えばチャーブ法などの狭い相関関数により、レーダー技術で周知の H F パルス圧縮法を利用することが可能である。その場合、個々の光混合素子の変調信号と、所定の位相関係で照射される送信器の光波と、調査対称の位相関係で反射される光波とは、チャーブによって繰り返し変調される。チャーブ変調により、適当な方法で、光混合素子の変調光ゲート電圧と送信器によって照射される光の間に調整可能な遅延を挿入することにより、多くの課題が解決され、または照明されているシーンのやっかいな多重反射が抑制される。

以下に記載する擬似ノイズ変調 (P N 変調) は、ベースバンド P N 変調および H F - P N 変調といった別の形態の変調として利用できる。繰返し光信号の場合の抽出-保持操作を利用するサンプリング手順は、ニードルパルスによる混合および相關の特殊ケースである。本発明による光混合素子は、パルス変調の前述および他の用途のために有利に利用できる。

言及される変調モードは、それ自体はすべて現状技術において周知である。

蓄積ゲートにドリフトされた電荷は、かくして種々方法による別の処理の対象となる。一方、光混合素子は、C C D 技術を利用して作製することができる。その場合、電荷は蓄積ゲートの下に集められずなわち集積され、その後、従来の方法によって、例えば3相シフトサイクルでC C D 読出回路に移動され、p 拡散またはn 拡散によって読み出される。

他方、光混合素子は、画素特定電子読出しおよび信号前処理システムを備えた能動画素としてC M O S 技術を利用して具現される。その場合、実際には、C C D 技術で公知の読出回路は、変調ゲートの両側に直接に取り付けられている。その場合、蓄積ゲートは、ブロック低容量 p n ダイオードの形であることが好ましく、到來した光発生電荷は、好ましくは電極 G_a および G_b によって、電子画素読

出しおよび信号前処理システムに転送され、そこで記憶および処理される。

したがって、後者の場合、チャージスイングの2つの電荷成分は連続的に読み

出され、例えば電荷増幅器により、下流に接続した各キャパシタに実質的にリアクションフリーに記憶される。

それぞれの新測定操作以前に、現状技術において、関連荷電キャパシタが電子リセットスイッチによって放電され、望ましくはリセット状態のときに測定した故障電圧を実際の測定値の修正に利用することが行われている。画素に関してリアクションフリーの読み出手順を利用することにより、C C D技術を利用して実施した場合と比較して、光混合素子の全体動力学ならびにそれを利用する測定方法が著しく改善される、という利点が提供される。

別的好適方法において、好ましくはオンチップ集積の形態で、電子画素読み出しおよび信号前処理システムで位相および振幅情報を直接計算できる。そのような特定用途光電チップ（A S O C）またはそのような能動画素センサ（A P S）により、測定速度が向上し、画素に関する位相および／または振幅の前処理が可能となる。

本発明の重要利点は、電荷の発生および分離と同時に変調が行われることである。つまり、検出と混合が、同時に、しかも余分なノイズや帯域制限を伴う中間段階無しで、実行される。したがって、特に現状技術において生じてしまうタイムドリフトエラーが防止され、時間および空間の点で検出操作とは切り離される電荷変調と集積動作が必然的に生じるが、これらが抑制を受けることはない。

本発明の更に別の利点は、光混合素子の上限周波数である。プッシュプル変調電圧による電荷転送の限界周波数は、最大ドリフト長または転送距離、つまり変調光ゲートの全長の点で、関係M O Sトランジスタの限界周波数に匹敵し、従ってG H zレンジに達する。また、面倒なコモンモード信号は反対称電荷キャリアの分離および差分形成（d i f f e r e n c e f o r m a t i o n）によって抑制される。例えば背景照明など、変調信号と相關しない各干渉信号は、電荷差が除かれて、結果的に信号対ノイズ比が高くなる。また、同一チップ上で、検出、混合、電荷キャリア集積、および差分形成を組み合わせることにより、わずかな

タイムドリフトだけになる。また、單一半導体構造内で、実質的に全部の測定関

数を併合処理することが可能となる。

変調器としてポッケルスセルを利用したドイツ特許出願公開明細書第44 3 9 298号に開示されている最新技術と比較した場合、必要変調電圧は、100ボルトレンジではなく、1ボルトレンジという僅かな変調電圧に過ぎない。また、本発明による光混合素子の2次元配列では、受信器側に大きな開口が確保される。

また、位相および／または振幅情報を求めるのに際してコヒーレント光も偏光も不要である。したがって、例えば、光の偏りおよび波長に対応する選択フィルタを上流に配置することにより、入射光波の他の特定特性を利用できる。更に、当該配置によって、現状技術で利用されている電子ミキサおよび広帯域光検出増幅器を排除することにより、高レベルな感度がもたらされる。

調査対象である光波のスペクトル帯幅は、光ゲートの下の空間電荷領域に使用される材料のスペクトル感光度によって決まる。すなわち、例えば、シリコンの場合は約0.3～1.1μmの波長範囲、InGaAsの場合は約0.8～1.6μmの範囲、InSbの場合は約1～5.5μmの範囲である。

光混合素子は、0次元、1次元、または2次元構成で配置することが可能であり、従って、スペクトルの広い使用幾何学形状を実現できる。これに関し、例えば、各画素の距離情報を求めて3次元シーンのカメラショットを極めて高速に実現できるように、例えば10～1000MHzの変調帯域幅で数十万個の光混合素子を並列関係に作動させることができる。位相画像ψ(x, y)または(変調照明の場合)動径ベクトルまたはボクセル距離による距離画像または深さ画像R(x, y)は、蓄積ゲートに供給されて読み出される電荷の荷電差によって画素的に求められる。関係電荷の合計から、従来の画素濃淡値A(x, y)が得られる。この2つを組み合わせることにより、階調画像または3次元画像A(x, y, z)が得られる。

これに関し、3次元画像繰返し率は約10Hz～千数百Hzの範囲内で、使用光混合素子の数と光強度のレベルに依存している。追加カラーフィルタにより、

距離画像R(x, y)の通常カラー値、赤(x, y)、緑(x, y)、青(x, y)を

得ることができる。

特に混合および電荷キャリアを集積する集積構造により、光混合素子に関して単純な構造が提供される。結局、1点だけでなく1次元または2次元のシーンを記録する場合、反射する可能性のある入射光波の画像形成には、従来の光学的画像形成システムで十分であるので、受信チャネルに特別に費用をかける必要がない。測定装置は、光送受信システムの同期ズームによって種々の3次元シーンに柔軟に対応できる。

本発明による方法、および、対応する混合素子または複数混合素子配列の場合、画素の位相すなわち画素トランシット時間および画素輝度が、能動画素センサ構造（A P S）によって直接確認されるのであれば、好ましくは同一チップ上に配置された多重構造（いわゆる、オンチップ多重構造）によって選択的または連続的に読み出されることが望ましい。これにより、処理速度が向上し、また、他の所要要素数が減少する。

濃淡画像のように、更に画素の輝度を関連蓄積ゲートの電荷合計として評価する場合、特に好適な本発明の実施態様は、背景照明の場合、つまり、変調光の横にある非変調光の場合に、一方で照明オン時、他方で変調光が無い状態つまり変調光源切断後で実現される濃淡画像間の差を生じる手順により、蓄積ゲートの上記追加照明によって生じた電荷を計算によって除去する。蓄積ゲートの基本輝度または基本電荷量には相関情報が含まれていないので、実際の相関情報は、基本量を差し引いた後に更に明瞭に示される。

前述のように、該実施態様が、線状アレイ、面状アレイ、または空間状アレイのいずれかで複数の混合素子を使用する場合に適していることは明白である。ここで「線状」アレイという用語は、まっすぐな列に並んでまたは連続的に配置した混合素子一式のみを意味するのではなく、一般に、まっすぐかもしれないし、曲がっているかもしれない線に沿って配置されている混合素子一式のことを意味する。面状配列の場合、混合素子は原則として、実際的理由から好適であるにせよ、矩形行列の形態の平面状の混合素子アレイだけでなく、例えば球面シェルの

内面の曲面上など、任意の所望パターンで配列できる。また、ある角度をなす複

数の表面、すなわち、互いに1つの角度を含む2つの表面上に同時に混合素子のアレイを適用することも可能であり、そのような配列は一部の用途に適している。この種の配列は、「空間状アレイ」という用語で表される。

複数の、場合によっては数百または数千の混合素子から成る前述のアレイの場合、本発明による方法の有利で望ましい構成は、画素または混合素子の少なくとも1つが、照明として作用する輝度変調電磁波の一部によって直接照射される構成であり、その場合、そのようにして得られた測定結果は、前述の少なくとも1つの画素で、別の位相および輝度の結果を較正するために使用される。これに関しては、そのような画素が送信器によって選択的に異なる輝度レベルで活性化される場合、または、複数の基準画素が使用される状況下でそれら各画素が別々のレベルで活性化される場合に望ましい。これにより、測定信号の大きな動的スコープによって起こりうるエラーを回避することが可能となる。

これは、前述種類の1次元以上の混合素子配列の場合に、MOS技術を利用してシリコン基板上に画素を作製し、それらの画素を好ましくはCCD構造を備えた多重構造を利用して読み出せるのであれば、好ましい。

本発明による混合画素は、デジタル写真カメラまたはビデオカメラに用いるのに特に適していることを理解されたい。この目的のために必要なことは、集積受信光学系と、電子評価系と、そこから計算される濃淡値およびトランシット時間または距離画像用にデジタルメモリを備えた、種々の信号、合計信号および関連基準信号の信号処理系と、を有している適切な混合素子配列（例えば、矩形行列の形）を用意することだけである。該配列は、適切な送信器、または変調電磁波か変調光によって3次元シーンを照らす適切な光源、および受信光学系に応じて適切に調節できる送信光学系も備えており、これらの構成要素がすべて組み合わされてデジタルカメラとしての小型装置を構成する。これに関し、デジタル写真カメラとデジタルビデオカメラの違いは、基本的には、関係ビデオカメラではかなり多数の画像を相当に短い時間間隔で記録および記憶しなくてはならないので、関係画像シーケンスの記憶および再生に適した装置を用意しなくてはならない

ということだけである。

また、すべての用途において、シーンの照明は種々スペクトル領域の変調光によってのみ行われるので、そのようにして得られた画像の色成分すなわち色彩成分を、同時供給される空間的深さ情報と共に利用することにより、完全なカラー画像を獲得および再現できることを理解されたい。

より高い帯域幅の場合、および、例えば効果的エッジ検出の場合も、特に感光面のエッジ部に生じる変調ゲートの理想電位構成からの逸脱が実質的に排除されるように、画素中央部への入射光を少なくする微小レンズ光学系を、混合素子または画素と関連付けて用いることが望ましい場合がある。微小レンズ光学系によつてもたらされる、混合素子の検出器平面のピンぼけ画像形成によって保証されることは、2つの半画素間の中央にランダムに広がるエッジの画像生成によって、相関関係または誤った深さ情報をシミュレートする種々の電荷を蓄積ゲートに生じないことである。

本発明による光混合素子を備えたアレイは、問題となっている配列という観点から、また、探索対象、場合によっては追跡対象となっている物体の深さ情報をすなわち物体距離に対して付加的なされる検討によって、所定の1、2、または3次元構造を検出したり、場合によっては追跡するのにも、極めて適している。

具体的観点から言うと、変調信号の振幅と、変調信号のX座標、Y座標、および時間座標T(ここで、XとYは混合素子行列の平面上に伸びる2つの1次独立座標であり、時間Tは変調信号のトランシット時間の遅延を意味する)の変位(ΔX 、 ΔY 、 ΔT)によって3次元相関が実現され、それによって所定空間内で所定3次元物体が探索され、検出され、場合によっては追跡される。

本発明による光混合素子は、更に、光データ転送の分野においても広範囲な用途がある。これに関し、本発明による光混合素子は、単に、場合によっては信号再生を伴う従来の信号受信器の光ダイオードに代わって使用され、その場合、変調信号の形状は最適方法によって信号形状に適合され、変調信号の位相は位相ロックループにおいて最適方法によって受信信号の位相位置に適合される。つまり、信号自体からクロックが選られ、該クロックは、受信信号の最適重み付けに利用

され、それにより、信号をノイズのある面倒な背景から最適方法で分離することができる。このように、従来の光ダイオードと比較して、光データ伝送の感度と精度を大幅に向かうことができる。これにより、中間増幅を行ったり、時間、周波数、および多重コードモードの並列通信チャネルを増やしたりせずに、光送信部の長さを大幅に増大することもできる。

最後に、本発明による光混合素子は、例えば、信号を符号化出力できる衛星送信機によって極めて正確な位置測定を提供する公知G P Sシステムに組み込まれているものと基本的に同様な操作モードを備えた光学系の位置検出システムに利用することも可能である。当該光学式位置検出システムでは、G P Sシステムで公知の衛星送信機を、例えばレーザダイオードおよび光拡散または分散システムで位置を調べる物体の、より近くに相応に配置される広分散変調光源と交換し、一方、受信機は物体の1つ以上の光混合素子によって、好ましくは、種々の変調により種々の点に固定的に配置された光源からの信号を検出するために種々の方向に向けられた複数の光混合素子によって、形成される。その場合、関係信号トランシット時間と同様に、コード化変調によって、固定光源と、位置を知りたい物体と、が明確に関係付けられ、それによって位置を求めることができる。

更に別の用途は、光データ伝送用のデマルチプレクサという使い方である。光混合素子による特殊変調および関連相関という形のコード化により、種々のチャネルを明確に関係付けることができる。

本発明による光混合素子の高レベルな位相感度の更に別の用途および使い方は、サニヤック (S a g n a c) 効果の測定、すなわち、回転基準系の光波のトランシット時間すなわち位相シフトの測定である。この目的のために、変調光は好ましくは何回かターンさせて敷設してある光ファイバに結合され、光ファイバの出力によって本発明による光混合素子の1つを照射する。この混合素子の変調ゲートは、供給された光波と同じ周波数で変調されるので、光混合素子における電荷分布という形態の相関結果から、現在の周波数または位相シフトに関する測定値を求めることができる。回転軸が光ファイバまたは導波路のターン部の平面にない基準系を1回転する間に、周波数とトランシット時間、およびそれに伴って位

相位置も変化し、それらは光混合素子によって自動的に検出される。これに関して言うと、光混合素子を使って、非コヒーレント光によって前述のサニャック効果を基礎とするファイバジャイロコンパスシステムを実現でき、しかも該ジャイロコンパスシステムは現状技術による対応エラー源として長期安定性関連の問題を生じることはなく、光検出器下流の高周波増幅器および電子ミキサが完全に除去されることは注目に値する。

また、本発明による光混合素子によって、前述のシステムで実現される絶対方向測定の他に、例えば、一部の光波が、光導波管に誘導される以前にビームスプリッタ内で除去されて静止物体の方に向けられることによって、移動物体の速度測定を実施することも可能である。その場合、静止物体から反射した光が適切な光混合素子受信器によって捕捉され、既に複数事例について説明した方法により、ここではドップラ周波数偏位について評価される。、

直線画像または行列画像の付加的深さ情報の個々の意味と重要性に応じて、任意の数の光混合素子を、CCD-、CMOS-、またはTFA (ASIC上の薄膜) -画像センサの適切な技術で集積することが可能である。

また、本発明による3次元直線または行列カメラを使用する場合、従来の2次元カメラを付加的に使うことが適切な場合があり、その場合、3次元カメラへの能動変調照明素子および他の非変調照明素子のスペクトル割当てと供給をビームスプリッタによって実行することが好ましい。

3次元測定または調査で光混合画素を利用するときに、距離が大きくて変調光が弱すぎる場合、少なくとも2つの3次元直線または行列カメラを組み合わせたものを使うことが可能である。その場合、本発明による測定または調査は、近傍領域ではトランシット時間原理を基礎として、遠方領域では特に既存の背景照明を利用した三角測量原理を基礎として行われる。

その場合、近傍領域の深さ測定は、この場合は少なくとも2つのカメラで並行に、先述した通りに実施される。

遠方領域の深さ測定の場合、PMDチップの中央点を通るように形成されたカメラの光軸が、例えばPMDチップを水平および垂直方向およびPMDチップ間

隔を基準として適切に移動させることによって、測定対象の体積領域の共通交差点に向けられ、それと同時に、カメラの光学系の焦点がこの距離に設定される。事前に適切な調節を行うことにより、画素の輝度値が該体積領域の最大の深さ鮮銳度と符合する。

当該体積領域内で物体を検出および識別するときに、差分画像に関して、画素の振幅が一致する場合、短時間に印加される交流変調電圧によって光混合素子の総和画像 (sum image) が追加され、該総和画像は設定距離データと関連付けて評価され、一方、一致しない画素の振幅は、ゼロに設定した変調電圧 $U_{ss} = U_{sb} = 0$ によって差分画像から除去される。

このように、変調送信器照明の範囲外も、角度走査によって測定および調査される。このとき、所要角度は、PMDチップの適切移動と、各ステレオカメラの回転と、および／または装置全体の振動によって達成される。

多数の可能用途のはんの一部を、本明細書中に部分的に詳細に、または部分的に簡単に説明した。これらの可能用途は、それ以外の可能用途も記した以下の表にも記載されている。その更なる説明は本発明の適用範囲を超えるものであり、その点で、以下の表は決して徹底したものではない。

更に具体的に述べると、可能用途は、以下の領域において有意であるとともに、構想可能である。

- デジタル式3次元写真カメラ
- デジタル式3次元ビデオカメラ
- 危険領域監視
- セキュリティ技術と「インテリジェントビル」
- 自動車の乗員の検出および識別「インテリジェントエアバッグ」
- 電子式3次元バックミラー
- 道路交通の交通状況認識
- 自律性車両のナビゲーション
- 非コヒーレントファイバジャイロとドップラー速度測定
- 自律性輸送車両の制御

- 産業クリーニングロボット
- 個人識別、アクセス権の証明および確認
- 例えは車両などの物体の識別
- 生産監視、材料試験、100%品質試験
- ロボットハンドおよび強靭で小型のあらゆるソリッドステートの「3次元アイ」、
- 車両速度および走行距離測定、道路状況検出、交通渋滞
- トラックフリー信号、線路上の接触ワイヤ監視
- 医用工学、内視鏡検査
- 光学式自由空間またはライン通信のためC D M A技術
- 例えは、マルチメディア領域における会話形3次元通信
- 1列の光混合素子による移動物体の3次元測定

これに関し、本発明の光混合素子（以下、「光ミキサデバイス」を表す“P M D”と略す）は、以下の長所に重点が置かれている。

1. P M Dの組合せ： $1/100 \sim 1/1000 \text{ mm}^2$ という極めて小さい空間に、検出、プッシュプル、混合および集積を組み込んである→電気—光学の相関。
2. 2倍／4倍P M D：優れた動特性およびグループトランシット時間定常性を備えた2個または4個の高価な広帯域増幅器、および、それぞれ2個または4個の電子ミキサと、取り替えた。
3. 送信器と受信器の間の高レベルな電子クロストーク感度を解消。
4. 数十万個の並列電気光学変調器を備えた高レベルな集積性。
5. P M D—3次元写真またはビデオカメラは、光送受信器用の光ズームシステムにより、完全統合可能であり、しかも小型、軽量、強靭で、柔軟に適応可能。開口角約 $5^\circ \sim 50^\circ$ で、距離約 $20 \text{ cm} \sim 50 \text{ m}$ という自然表面測定ボリューム。
6. 10 H z \sim 1000 H zレンジの超高速3次元画像記録。感度およびS/N比は、現在のC C DまたはC M O Sカメラに対応。

7. 予想深さ分解能は、各測定時間、照明強度、関連光学、および最適基準による間隔に応じ、約0.5 mm～50 mm。

8. GHz レンジまでの各画素サイズに応じて最大帯域幅。

9. 1 ボルト未満の範囲の変調電圧。

10. 無コヒーレント光、偏光、または狭帯域光が要求され、スペクトル領域は感光材料に対応(例えば、InSb の場合は、5.5 μm 以下)。

11. データ融合による3次元深さ画像および2次元濃淡値画像の同時記録により、3次元濃淡値画像(または3次元カラー画像)の最適評価を実現。

12. 集積時間 T_i を強度に応じて変更することにより、読み出回路が約8ビットずつダイナミックを増加できる。

ここで、図面を参照しながら、実施例によって与えられる実施態様を介して本発明を以下に更に詳細に説明する。

図1のa)は、CCD技術を利用した本発明による光混合素子の第1の実施例の画素断面図である、b)～f)は、2つの相補形変調光ゲート電圧 U_{se} (t)と U_{ba} (t)の種々の位相および時間のポテンシャル分布 $U_s(t)$ である。

図2は、ライン間伝送読み出装置の一部を含むCCD技術を利用した2つの線形配置画素のブロック図である。

図3は、入射光の強度分布と、HF変調の場合の電圧 $U_{sep}(t)$ 、 $U_a(t)$ 、 $U_{ba}(t)$ 、 $U_{bs}(t)$ 、および $U_b(t)$ の電位パターンを示す図である。

図4は、相対位相なわちトランシット時間シフト $\psi_{opt} = \omega_b \tau$ に対応するHF変

調の場合に、蓄積ゲートにドリフトする平均化光発生電荷キャリア電流 \bar{i}_a および \bar{i}_b の形で光混合素子の混合および相関結果の特性を示す図である。

図5はPN変調の図で、a)に変調信号を示し、b)に T_b の第3および第4

の変調ゲート c m および d m の変調信号遅延の場合の、2重画素 (\bar{i}_a および \bar{i}_b のみ) および \bar{i}_a と \bar{i}_b を備えた4重画素の混合および相関結果の特性を示し、c) に距離評価に関連する差分値 $\Delta \bar{i}_{ab} + \Delta \bar{i}_{cd} = \bar{i}_a - \bar{i}_b + (\bar{i}_c - \bar{i}_d)$ および $\Delta \bar{i}_{ab} - \Delta \bar{i}_{cd} = \bar{i}_a - \bar{i}_b - (\bar{i}_c - \bar{i}_d)$ を示す。

図6のa)は、変調光ゲートおよび蓄積ゲート下に中間変調光ゲート G_0 とポ

テンシャル分布を備えた本発明による光混合素子のCCD技術を利用した第2の実施態様の画素の断面図であり、b)が正、c)が負の変調電圧 U_t (t) の場合の図である。

図7のa)は、本発明による光混合素子の第3の実施態様の画素の断面図であり、b)～f)は、図1と同様の種々位相のポテンシャル分布を示す図である。

図8は、4重画素と呼ばれる、4つの変調光ゲートと4つの蓄積ゲートとを備えた本発明による光混合素子の第4の実施例の画素を示す平面図である。

図9は、4つの変調光ゲートと、4つの蓄積ゲートと、中央対称中間ゲート G_0 とを備えた本発明による光混合素子の第5の実施例の画素を示す平面図である。

図10は、光波の位相および振幅情報を調べるための、現状技術で周知の装置の線図である。

図11は、高周波変調の場合の光波の位相および振幅情報を調べるための本発明による装置の線図である。

図12は、例えば、PN変調または矩形変調の場合の光波の位相および振幅情報を調べるための、本発明による装置の線図である。

図13のa)は、CMOS技術を利用した電子画素読出しおよび前処理システムを備えた本発明による光混合素子の第6の実施態様の画素の断面図であり、b)とc)は、変調光ゲート電圧の2つの位相または極性のための、図6と同様なポテンシャル分布を示す図である。

図14は、好ましくはデジタル変調用の、4つの変調光ゲートと4つの蓄積ゲートと中間ゲート G_0 とを備えた、十字形に構成された光混合素子の第6の実施

例の画素の平面図である。

図1 aに、CCD構造の実施例を用いた光混合素子の独立素子1の断面図を示す。この場合、光混合素子は、画素1の他に、電圧供給および信号データオフ動作に必要な構造を備えている。外側ゲート G_{sep} は、隣接構造に対して当該画素の境界を電気的に定める役割しかない。

図1記載の配列は、p添加シリコン基板2上に形成されている。まず最初に、提案概念である混合すなわち乗法演算に関連して、純粋なCW高周波変調の場合

について検討する。

断面に関して言うと、図1 b～fは、混合手順の種々位相のポテンシャル分布を模式的に示している。中間変調光ゲート G_a と G_b は感光部で、反転状態にある。これらは、例えばポリシリコンの導電性すなわち一部が光学的に透明な上カバーの正のバイアス電圧 U_0 と、重疊ブッシュブル電圧 U_n (t)とによって作動される。これにより、変調電圧 $U_{an}(t) = U_0 + U_n(t)$ および $U_{bn}(t) = U_0 - U_n(t)$ がそれぞれ与えられる。

これらは、例えば酸化シリコンまたは窒化シリコンから成る絶縁層3の真下にある空間電荷領域の入射光波の光子によって生成される負電荷キャリアを乗法により分離させる。これらの電荷キャリア（当該実施例では、電子）は、変調ブッシュブル電圧の影響を受けて、正の蓄積ゲート G_a または G_b のごく近傍にドリフトし、そこで集積されるが、多数の電荷キャリアまたはホールはp-Si基板の接地端子に流れる。後方照明も可能である。

図2に、相関によって得られる電荷値の逐次処理用に拡散接合を備えた電子読み出しシステムを一端に配した、3次元CCDシフトレジスタの形態のライン間伝送読み出し装置7の一部を含む、本発明による光混合素子の2つの画素1の平面図である。例えば、n番の画素のラインの全蓄積ゲート下の電荷蓄積に要する所定時間Tの後、 G_a および G_b の下の電荷 q_a および q_b は、それぞれトランスマニアゲート TG_a および TG_b を介して、3相読み出しシフトレジスタに渡される。境界分離ゲート G_{sep} は、望ましくない外部影響から相関画素を保護する。境界分離ゲート G_{sep} は接地電位であることが好ましい。

図3に、図1に関連する電圧構成を示す。変調光ゲート G_a および G_b は、位相対立HF変調電圧 U_a (t) を含む図3記載の変調光ゲート電圧によって作動される。変調光ゲート電圧は次のように示される。

$$U_a = U_0 + U_1 \cos(\omega_a t) \quad (1a)$$

および

$$U_b = U_0 + U_1 \cos(\omega_a t - 180^\circ) \quad (1b)$$

$$= U_0 - U_1 \cos(\omega_a t) \quad (1b)$$

図1b～fでは、HF変調信号の期間 T_a 内の $t_1 \sim t_2$ の時間系列における、代表的画素1の問題の全ゲートの、該画素1の空間的範囲を超える空間電荷領域のポテンシャル分布 $U_s(s)$ がはっきりと示されている。相対的に高い正電圧により、光発生電荷キャリアが、変調光ゲート電圧 U_a (t) および U_b (t) の極性に応じて、図1に断面を示した画素1の左側または右側に向かって大多数がドリフトした後に、蓄積ゲート G_a と G_b に蓄積される。この動作は、光変調電圧と変調光ゲート電圧 U_a (t) が同じ周波数を備えているときに特定の効果を呈する。それぞれの位相差 ψ_{opt} に応じた、蓄積ゲート G_a および G_b への電荷キャリア

リアドリフトの平均優先方向が存在する。関連平均化電流は \bar{i}_a および \bar{i}_b で表され

る。

基礎となる相関手順は、数学的に次のように説明される。光混合素子の2次元アレイの最も一般的な場合の受信平面では、 $z = 0$ で、入射変調光波は一般に P_{opt} ($x, y, t - \tau$) で表される。入射変調光波は、そこで作用するプッシュプル変調信号を備えた光発生電荷キャリアによって、 $U_a(x, y, z)$ という一般的な形で表され、2つの蓄積ゲートの電荷差について概算乗算または概算積分によってリンクされる。対応する相関関数 ψ_{ab} (x, y, t) は、例えば、蓄積ゲート G_a および G_b への電荷キャリアドリフトの全平均化差分 Δq_{ab}

$\Delta q_{ab} = \bar{i}_a - \bar{i}_b$ ($T = \text{積分時間}$) について、最も一般的な場合、位置に応じ

て、次のトリプルコンボリューションとして表現される。

$$\varphi_{U_m, P_{opt}}(x, y, \tau) = k_1 U_m(-x, -y, \tau) * * * P_{opt}(x, y, \tau) = k_2 \Delta \bar{i}_{ab}(x, y, \tau) \quad (2)$$

但し、トランシット時間差 $\tau = \psi_{opt} / \omega$ 、変調角周波数 ω および、構造依存であるが動作原理の点で重要でない定数 k_1 および k_2 で表される。

本発明による光混合素子は、光電子の分離電荷高速転送と、そのプッシュプル

記憶と、差分および合計評価により、高い位置および時間分解能レベルで前述の目的を達成する。これに関し、不安定な光波の場合に時間依存の平均化ドリフト電流差 $\Delta \bar{i}_{ab}(t) = \bar{i}_a(t) - \bar{i}_b(t)$ を生じることによって、厄介なあらゆ

る偏り成分が抑制され、同時に、変調電圧 $U_m(t)$ により光信号 $P_{opt}(t - \tau)$ に関して所望の相関関数が構成される。

この手順を以下に詳しく説明する。 $U_m(t)$ および $U_{bm}(t)$ によって生じるHFドリフト電界により、それぞれ正の側への電子がドリフトされる。例えば、変調光ゲート電圧 $U_m(t) = U_0 + U_m(t)$ の正の半波のとき、すなわち $U_{bm}(t) = U_0 - U_m(t)$ の負の半波のときに、光発生電荷キャリアが蓄積ゲート G_m にドリフトし、そこで電荷量 q_m として集積または渡される(図1bとcの上2つの変調光ゲート電圧分布を参照)。図3では、安定した調和変調照明の場合の1画素あたりの光強度が次のように示される。

$$P_{opt}(t - \tau) = P_0 + P_m \cos(\omega_m t - \psi_{opt}) \quad (3)$$

式中、 P_0 はバックグラウンド照明を含む平均値であり、 P_m は変調振幅であり、 ω_m はHF変調周波数であり、 ψ_{opt} は位相遅延であり、 $\tau = \psi_{opt} / \omega_m$ は変調位相 G_m に対する入射光波の対応トランシット時間遅延である。1画素当たりの総発生電流は次の通りである。

$$i(t) = S_a \cdot P_{opt}(t - \tau) = S_a \cdot [P_0 + P_m \cos(\omega_m t - \psi_{opt})] \quad (4)$$

$$i(t) = I_0 + I_m \cdot \cos(\omega_m t - \psi_{opt}) \quad (5)$$

ここで、パラメータ $i_a(t) = i_a(t) + i_b(t)$ 、 I_a は P_a に基づく画素光電流の平均値、 I_b は P_b に基づく変調光電流の交互振幅、 S_a はスペクトル感度である。この1画素あたりの総光電流は、2つの成分、具体的に述べると、蓄積

ゲート G_a の電流 $i_a(t)$ と蓄積ゲート G_b の電流 $i_b(t)$ に分けられる。これらの値は、CCD技術の場合はそれぞれの蓄積ゲート G_a および G_b の下で統合され、画素に関して読み出しが行うCMOS技術の場合は好ましくは電子読み出しシステムの中で統合され、これら電流の平均値 \bar{i}_a および \bar{i}_b を以下で考慮する上で

何の支障もない。最大の電荷分離は、角度 $\psi_{opt} = 0$ 、 $\tau = 0$ で達成される。この状況を図3に示す。

適切な変調振幅、無視できるほどのドリフトランシット時間、 $p_a = P_a$ の100%変調深さなど、平均光電流 \bar{i}_a および \bar{i}_b にとって理想化状態にあると想定す

ると、調和変調によって以下が与えられる。

$$\bar{i}_a = \frac{I_a}{2} + \frac{I_m}{\pi} \cos(\varphi_{opt}) \quad (6)$$

$$\bar{i}_b = \frac{I_b}{2} + \frac{I_m}{\pi} \cos(\varphi_{opt}) \quad (7)$$

図4に、前述の理想化平均画素電流の構成を示す。これらは、HF変調受信光と、変調光ゲート G_a および G_b に印加されるHF変調光ゲート電圧とに起因する、逆位相形相關関数である。その合計は、平均光パワー P_a に相当する。時間 $T = N * T_s$ にわたって（すなわち、HF変調電圧のN回の期間 T_s にわたって）蓄積される総電荷量により、以下が与えられる。

$$\bar{i}_a(\tau) \cdot T = q_{at}(\tau) = \frac{I_a}{2} + \text{const.} \int_0^T P_{opt}(t - \tau) \cdot U_a(t) \cdot dt \quad (8)$$

ここで、位相遅延に対応するランシット時間 $\tau = \psi_{opt} / \omega$ である。以下、 q_{at} は、 q_a だけで示す。全部の画素1の蓄積ゲート G_a および G_b それぞれの電荷

総計は、位置的に離散した2つのH F インタフェログラム、a-インタフェログラムおよびb-インタフェログラムを構成する。b-インタフェログラムはa-

インタフェログラムから 180° ずれており、それらの差分を出すことによって、求めようとしている、式(2)に示した、トランシット時間決定差分H F インタフェログラムが得られる。

図11は、光混合素子のアレイを基礎として直接混合を利用する本発明による3次元カメラの模式図である。図10に記載の現状技術で公知の3次元カメラの概念と比較して、図11では、光学的受動3次元物体を照射するための送信器4の変調を、レーザダイオードの電流の直接変調によって実施している。その場合、H F 発振器13によって変調がもたらされる。距離が大きい場合、例えば、好ましくは一般的な変調電流で、目の安全のために複数の波長から成る強力レーザダイオードアレイを使うことが有利である。

第1の光学系5は、物体6の表面に光波の画像を形成する。物体6から反射された光波は、次に、第2の光学系6を介して、光混合素子アレイ8の表面に投射される。

更に光混合素子アレイ8はH F 発振器13によって活性化されるが、この活性化は、H F 発振器13による、放射光波の位相に対する種々の位相シフトによって行われる。まだ光混合素子アレイ8の信号の評価がオンチップで行われていない場合には、評価装置9によって評価がなされる。

本発明による測定装置によれば、提案される3次元カメラの概念には、本発明による光混合素子アレイのほかに、高い絞り値の他の光変調器は不要であり、これによって経済的に有利な構造が提供される。

こうして得られた相関振幅から画素の位相 ϕ_{opt} を求めるために、ミキサ信号の異なる4つの信号の場合、前述のように、全部で4つの異なるインタフェログラムが使用される。ミキサ信号の4つの位相は、変調光ゲート電圧 U_{in} と U_{out} の位相関係が、 0° ／ 180° の状態から 90° ／ 270° の状態に切り換わった状況、すなわち 90° 遅延した状況で生じる。これにより、実際の、すなわち、同相成分に対する2つの対応仮想成分すなわち直交成分が与えられ、そこから、

求めている画素位相を前述の数式(10)によって計算できる。

同時に、この動作モードにより、背景の明るさおよび混合操作によってもたら

される厄介なオフセット電圧を解消できる。

また、一例として、光混合素子アレイの平面の好ましくは同一周波数の変調電圧 $U_v(x, y, t)$ を利用した2D相関によるCW変調3次元光波に関して記載した測定操作に加え、本発明による測定装置を、パルス形の変調信号と組み合わせて有利に利用することも可能である。

特に、光の疑似ノイズ変調は、3次元光波の高精度トランシット時間測定に有利である。一例として、光学的受動3次元物体の調査または測定するための実施態様を図12に示す。図11の調和変調に関わる実施態様と同様に、本発明による装置は、所定の強度でPN(疑似ノイズ)変調された光で3次元物体6を照射する適切な照明装置を有し、反射されて受信された光は、好ましくは発振器13によって生成される対応PN変調信号を利用して、相関手順にかけられる。

ワード長 $T_w = T_b (2^n - 1)$ が増加する、その種のPN信号に関する相関は、ビット幅 T_b と相等しい半値幅を有する三角ニードルパルスに似ており、従つて、全照明体積すなわち照明された全空間を明確かつ完全に測定するためには、変調光ゲートの同一信号形状の、光変調PN信号と復調PNブッシュプル電圧 $U_v(t)$ との間の相対遅延 T_d は、連続的または段階的に T_b 段で、最大エコートトランシット時間の全体遅延レンジを、少なくとも1度は通過しなければならない。この目的のため、制御および評価装置9によって遅延TDに関する調節ができる遅延部材11が役に立つ。

図5aに、矩形の15ビットPN系列の例に関して、変調信号 $U_m(t)$ を示す。光混合素子による相関の結果は、相対遅延 τ に関連して図5bに示した平均化ドリフト電流 \bar{i}_a および \bar{i}_b である。

図8、9、14に記載された、以下に説明する4倍画素の場合、変調光ゲート G_{ca} および G_{cb} に印加され、バイアス電圧 U_b に重畳されるブッシュプル変調光ゲート電圧は、変調光ゲート G_a および G_b に印加されるブッシュプル変調光ゲー

ト電圧に対して、 T_b だけ遅延されること、すなわち $U_{ab}(t) = U_a + U_b(t - T_b)$ および $U_{cd}(t) = U_c + U_d(t - T_b)$ が好ましく、それによって、非常に有利な振幅およびトランシット時間測定がもたらされる。

変調電圧に関する所定の遅延 T_d を除き、送信器 4 によって照射される光強度 $\text{const. } P_{opt}(t)$ は、同一 PN 信号構造を含む。反射は、エコートランシット時間後に光混合素子に達する。背景明度の無い理想的なケースでは、 $T_d = 0$ のそれぞれの相対トランシット時間遅延 τ に基づく、プッシュプル変調電圧との相関により、二重画素の場合は図 5 b 記載の平均画素電流 \bar{i}_a および \bar{i}_b となり、更に規定された T_b 時間のシフトがある四重画素の場合は \bar{i}_c および \bar{i}_d となる。最

初にこの相関特性から、例えば、前後に重なるように並べられた部分的に透明な複数の物体区別したり、多重反射を解消するために、同一動径ベクトル上で複数の物体反射が区別できることが分かる。

更に、図 5 c に記載されているように、平均ドリフト電流差の合計および差は、二重画素の場合は連続的に生成されることが好ましく、四重画素の場合はそれぞれ対応する電子画素読出および信号前処理システム 1 5 で同時に生成されることが好ましい。これにより、ゼロ以外の信号値が発生する $T_b \sim 2T_b$ 幅の測定ウインドウだけにあるような高感度測定が実現される。合計を評価することにより、最小振幅を基礎とする測定の妥当性を判断できる。また、差は有用な T_b 幅測定ウインドウで急勾配直線構成を示し、それにより、高分解能でトランシット時間を求めることができる。以下は、ここで理想的と考えられる例に該当する。

$$\tau = T_b + \frac{T_b}{2} - \left[\frac{\Delta \bar{i}_{ab} - \Delta \bar{i}_{cd}}{\Delta i_{ab} + \Delta i_{cd}} \right] * \frac{T_b}{2} \quad (9)$$

提案される対応光検出器アレイを基礎として PN 変調により 3 次元物体を光学的に測定するための対応測定装置のブロック図は、図 1 2 から分かるように、特に簡素な構造である点に特徴がある。この場合、発振器 1 0 および遅延部材 1 1 の他に、図 1 1 に記載のものと同じ構造が含まれている。

本発明によれば、かなり低レベルな分解能で速やかに距離を確認するために、

周期 T および好ましくは同一パルスおよび間隔持続時間 T_s の発振器 10 は、送信器 4 の単純な矩形変調を利用している。トランシット時間確認作業は式 (9)

に基づいて実施される。分解能のレベルは、2分の1に減少する周期持続時間 T にともなって段階的に増加する。その場合、第1の測定ステップの後に第2のステップが続く。第2のステップは、周期は同じであるが時間シフト $T_d = T/4$ がある。

一例として図1に記載されている、本発明による光混合素子の画素1の断面を、プッシュブル変調電圧によって生じる電位勾配に関して適した構成によって、その限界周波数について最適化することができる。これに関し、図6に一例として変調光ゲート G_{a1} と G_{b1} との間に中間ゲート G_c を配置した実施態様を記載する。該中間ゲートは、バイアス電圧 U_b であって、変調光ゲート G_{a1} および G_{b1} と共に3つの電位段階を構成することが好ましい。望まれるのは、できる限り均一な電位勾配、すなわち、できる限り一定な変調ドリフト電界であるが、これは2から3、またはそれ以上に段階数を増加することによって達成される。感光空間電荷領域においては、いずれにしても該段階の定義または断言の程度は、絶縁層3からの間隔にともなって減少する。この効果は、本発明による別の実施態様で、更に詳しく述べると、「埋設チャネル」として知られているもの、すなわち、絶縁層から数 μm 離れ、変調光ゲートの下のp基板にいくぶんか深く入っている、弱く不純物拡散されたnチャネルを使うことによって、利用される。蓄積ゲート G_a および G_b が光波によって点灯したり、余分な電荷キャリアが発生しないように、この配置構成は蓄積ゲート G_a および G_b のシェーディング12も有している。

図1のものと比較して、2つの変調光ゲートが共通の蓄積ゲート $G_{a,n}$ でそれぞれ分離されている点のみが異なっており、それによって、より高度な充填作用を達成する、光混合素子の特定の構成および接続を図7に示す。この配置構成も、蓄積ゲート G_a および G_b のシェーディング12を有している。この場合、プッシュブル変調電圧の極性すなわち $G_{a,n}$ および $G_{b,n}$ のシーケンスは画素毎に変

化する。このゲートの三重周期は、同時に、三相シフトレジスタとして作動させることによる直接読出しにも適している。ある種の応用装置については許容できる欠点は、それぞれの隣接画素にも及ぶ電荷分布であり、それによって見掛け画素サイズが大きくなつて対象方向の位置分解能が低下する。

これら内部関係および影響を計算することにより、電位差を評価すると、100%有効電荷と比較して、中央の画素がわずか50%しか得られず、隣接する2つの画素がそれぞれ25%ずつ得ると考えられる。

電荷分布を説明するために、図1と同様に、図7にCW変調のポテンシャル分布の種々の段階を示す。

図8に、CW変調の場合にI状態とQ状態の間でIQ(I:同相、Q:直角位相)の切換えを必要としない光混合素子の画素デザインの更に有利な実施態様を示す。前述の二重画素に代わって、変調光ゲートG_{aa}、G_{ba}、G_{ca}、およびG_{da}と、対応蓄積ゲートG_a、G_b、G_c、およびG_dを備える四重画素が提案される。該四重画素は、プッシュプル変調光ゲート電圧U_{aa}(t)、U_{ba}(t)、U_{ca}(t)およびU_{da}(t)が相互にシフトされる、特にHF変調の場合は90°シフトされるように、4つの位相位置について同時に相関させることができる、

従つて、前述の変調光ゲート $\psi_{aa} = 0^\circ$ のG_{aa}と $\psi_{ba} = 180^\circ$ のG_{ba}に関する直交配置に、画素内に対称に組み込まれて、同じ原理に基づいて作動する別の2つの変調光ゲート $\psi_{ca} = 90^\circ$ のG_{ca}と $\psi_{da} = 270^\circ$ のG_{da}が存在する。これにより、対応蓄積ゲートG_a、G_b、G_c、およびG_dの下、または、関連電子読出システムの中に独立した電荷q_a、q_b、q_c、およびq_dによる4相電荷蓄積がなされ、次のように、単純な算術演算によって、関連位相 ψ_{opt} が直接算出される。

$$\varphi_{opt} = \arctan \frac{q_c - q_e}{q_a - q_b} \quad (10)$$

個々の画素の濃淡値を簡単に求めるために、画素の全部の蓄積ゲートのここの電荷を合計する; $q_{pixel} = q_a + q_b + q_c + q_d$ 。4つの電荷それぞれに対応する読出プロセスは、この場合、画素の統合信号前処理を行うCMOS技術を利用す

るアクティブ画素デザインによって実施されることが好ましい。

図8と同様に、図9に光混合素子の四重画素を示すが、好ましくは電位U₀の中央矩形中間ゲートG₀によって、図6に記載されているように平滑な電位勾配

を備えている。

図9と同様に、図14に、デジタル変調信号に最適な構造を備えた光混合素子の四重画素を示す。好ましくは矩形の変調光ゲートの間に配置された中間ゲートG₀は、図9と同様な方法で、変調光ゲート電圧によってもたらされる電位勾配を平滑化する役割を果たす。

最後に第13図は、画素1の更に他の好適な実施例を示し、この実施例は、上で議論した実施例とは異なり、CCD技術を使用せず、電子画素的読み出しおよび信号前処理システム15と共にCMOS技術を使用して実行したものである。この場合、チャージスイング上の電荷キャリアの変調電圧依存ドリフトの動作モードは、上で議論した実施例と同一である。第13図に示す実施例の唯一の相違点は、蓄積ゲートG_aとG_bに対してドリフトした電荷q_aとq_bに対してそれ以外の処理を実行する方法である。

本実施例では、蓄積ゲートG_aとG_bは、ブロックpnダイードの形態である。これらの正にバイアスした蓄積ゲートG_aとG_bは、第13図において好ましくは弱く不純を拡散したp-Si基板上にn+不純物を拡散した電極を形成したものである。「フローティング拡散」動作モードとして知られているものまたは高抵抗電圧読み出しほどでは、CCD技術を使用する場合と同様に、電荷q_aとq_bは、蓄積ゲートG_aとG_bの容量上に集積し、電圧値の形で高抵抗モードで読み出す。

電流読み出しほどをまた有利に使用することが可能であり、このモードでは、光発生電荷キャリアはポテンシャルウエル内に集積されず、蓄積ゲートG_aとG_bにそれぞれ接続された適当な電流読み出し回路による出力拡散によって連続的に通過される。これらの電荷は、次に、例えば、それぞれの外部容量上に集積される。

画素を集中的に照射した場合、蓄積ゲート電圧を増幅器のフィードバックによ

って実質的に一定に保持する電流読み出しモードにおいて、読み出し回路は、蓄積電荷 q_a と q_b の量がポテンシャルウェル上における反応または実際上このポテンシャルウェルのオーバフローによって生じないことを保障する。これによって、光混合素子のダイナミックスが大幅に改善される。この場合、変調ゲートの

絶縁層の下に位置する弱く不純物を拡散した n チャンネル（「埋め込み層」）を含む上記の技術は、改善を行う、なかなか限界周波数を増加させることができる。

CMOS 技術を使用して光混合素子を構築すると、アクティブ画素設計（A P S）を使用することが更に可能になり、この場合、各画素において、読み出しあり信号前処理回路を光混合素子に集積することが可能になる。これによって、電気信号が外部回路に通過する前に、画素において信号を直接前処理することが可能になる。特に、この方法では、位相と振幅の情報をチップ上で直接計算することが可能になり、その結果、測定速度が更に速くなる。

本発明の更に他の構成では、例えば、物体の形状、位置、色彩、偏光、速度ベクトル、輝度または物体の性質の組合せの様々な種々の基準に基づいて、受動的または能動的に照明されている 3 次元物体の電子的サーチおよび追跡手順に対して、好ましくは 2 次元光混合素子のアレイを使用する。

例えば、最初は未知の入射光波の 3 D 測定における種々の変調信号（例えば、周波数またはコードの変更）の通路において、もし局部的な相関関係がゼロに等しくない差分ドリフト電流の基準によって見出されたなら、次にその物体の範囲を、できる限りその後に変化の発生した場合に、特に画像の深さをまた含む規制ループによって、特に上記の物体の性質に関して連続的に測定することができる。

この光混合素子は、以下で説明する種々の動作モードで使用される。

この点で、蓄積ゲート G_a と G_b における合計電荷は、これが入射光波の合計強度、 $q_a + q_b = \text{const.} * P_{\text{opt.ges}}$ * T に必ず対応し、ここで T = 統合時間であるので、重要ではない。

差分電荷 $\Delta q_{ab} = q_a - q_b = \bar{i}_a \cdot T - \bar{i}_b \cdot T$ は複数の要素によって決まり、入射光波を

測定するための多くの方法に使用することができる。この目的のため、必ず $P_0 > P_a$ (第3 a 図参照) である基本輝度に対して考慮を払う。

例えば、変調光によって送信器 4 の照明した物体 6 を任意に測定する場合、この送信器のパワーがオンまたはオフされ、従って P_a は有限数になるかまたはゼロに等しくなる。同時に、任意に変調電圧 $U_a(t)$ はゼロになるかまたは送信器に使用され、入射光に含まれているコンフィギュレーションに切り替えられる

か、または統合時間中一定である電圧 U_m に切り替えられる。

従って、 $P_0 \neq 0$ の場合、4つの重要な動作モードが与えられる。

- 1.) $P_a = 0$ と $U_m = 0$ の場合、 $\Delta q_{ab} = 0$ 。
- 2.) P_a が有限数であり、 $U_a(t)$ が HF 変調信号である場合、 $\Delta q_{ab} = 0$ 。
- 3.) P_a が有限数であり高周波変調信号 Δq_{ab} が $U_a(t)$ の関数である場合、相対的トランジット時間 τ と入力光パワー成分 $P_a(t)$ は、この方法で変調される。
- 4.) もし統合時間 T の間に、入射平均光強度 P_0 と一定変調電圧 U_m が存在すれば、差分電荷 Δq_{ab} は U_m と平均光パワー P_0 の関数である。

強度変調されていない光波の場合、本発明の更に他の構成によって、可能な動作モードの中の第4のケースに従って、例えば、2D 画像処理に対して光混合素子が提供され、使用される。

その場合、混合素子は、例えば、好ましくは RAM 素子によって高速上書き可能な U_m の個々の変調電圧ワードの画素的関係により、限定的かつ互いに独立に活性化できる。評価は、 U_m にはほぼ比例する差分電荷 $\Delta \bar{i}_{ab}$ および差分電流 $\Delta \bar{i}_{ab}$ についてのみ実施されることが好ましい。その場合、変調電圧 U_m は、

それぞれ変調電圧ワードから導き出される。

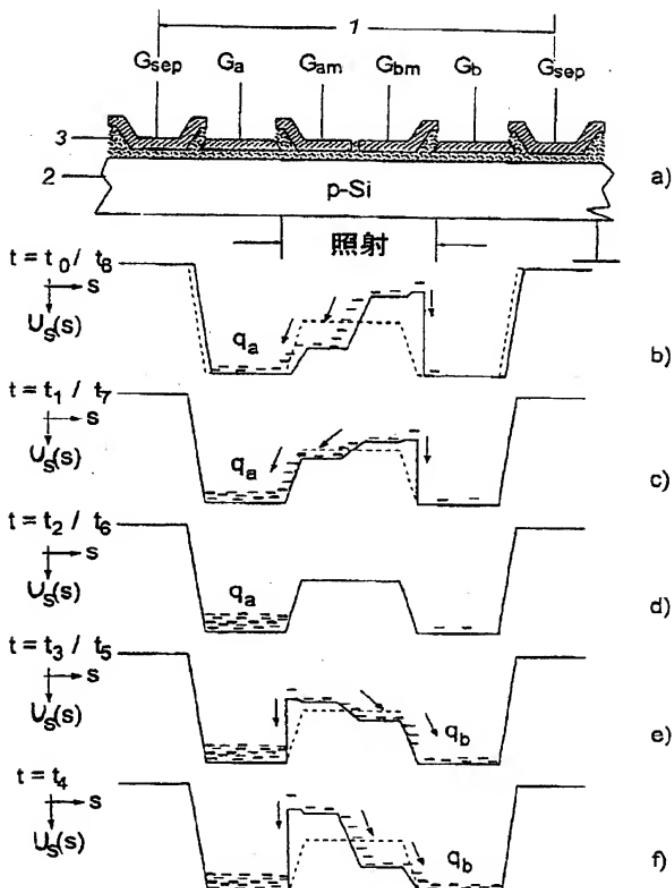
これは、 $U_a(t)$ の設定が、前述の使用例のように周期的または準周期的に行われるのではなく、例えば所定の画像内容に基づいてまたは測定された画像内

容に基づいて、非周期的に行われることを意味している。 $U_u(t) = 0$ の場合、すべての差分電流がゼロであるので、関連差分画像 $D(x, y)$ の振幅または輝度もゼロになる。

したがって、差分画像輝度は $U_u(x, y, t)$ の変動によって特に影響を受ける可能性がある。このように、本発明によれば、深さ情報の側面が無い場合を除き、例えば前述の物体探索用および追跡用などの、例えば前述の画素的に関連付けられた制御可能なメモリセルにより、あらゆる光波または画像に対して、すなわち変調されていないものに対しても、超高速設定可能な重み付け関数 $G(x, y, t) = K_u U_u(x, y, t)$ による多目的画像処理を施すことができる。

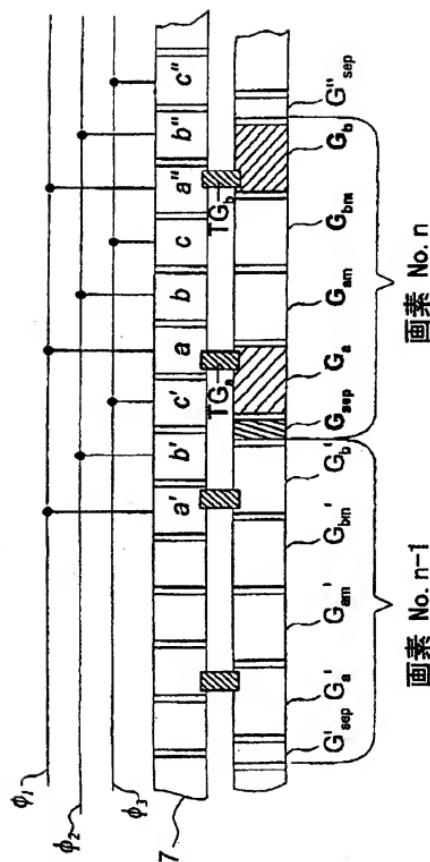
【図1】

【図1】



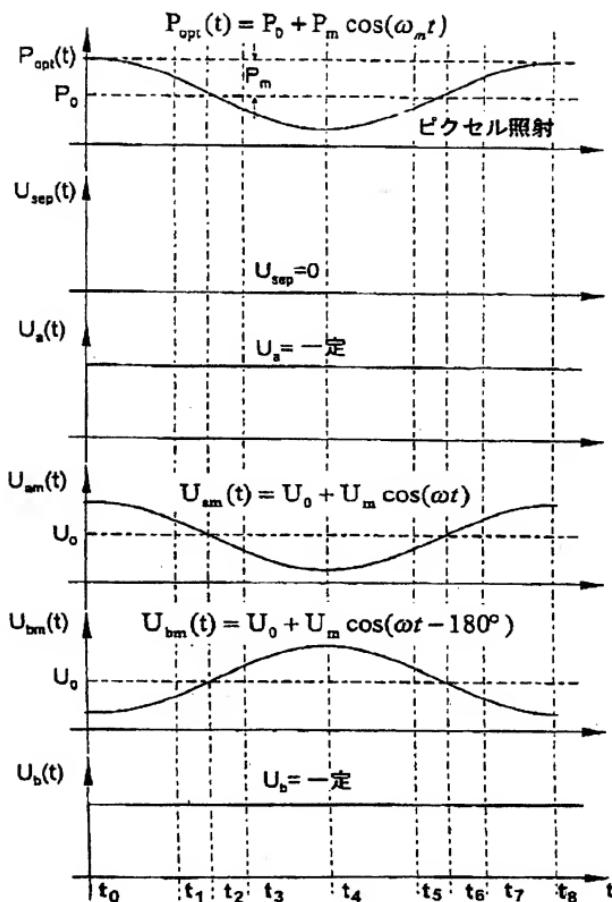
【図2】

【図2】



【図3】

【図3】



【図4】

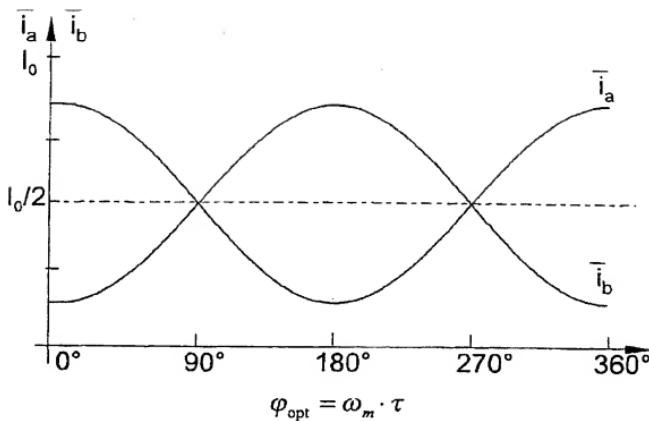


Fig. 4

【図5】

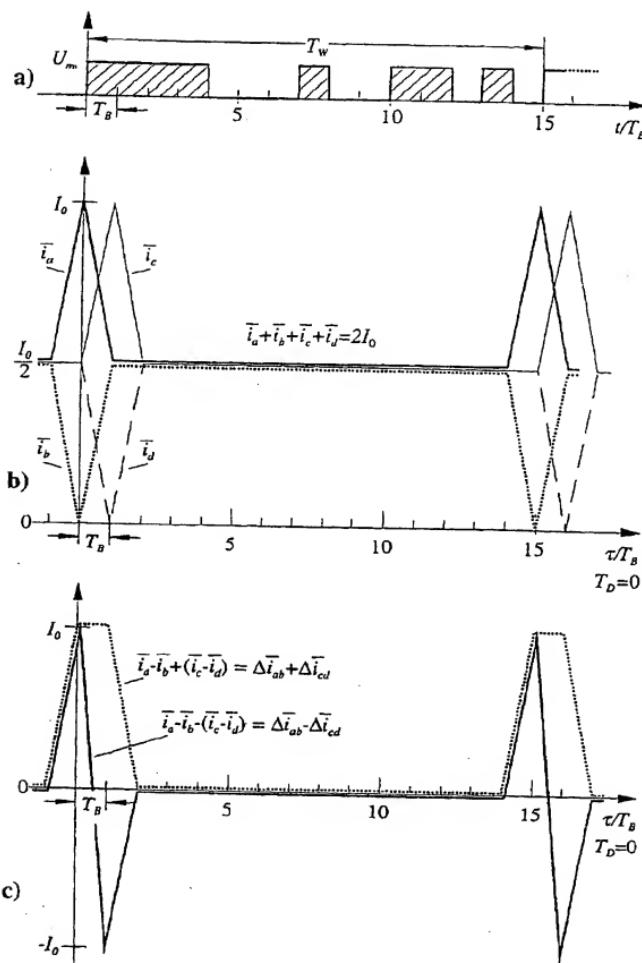


Fig. 5

【図6】

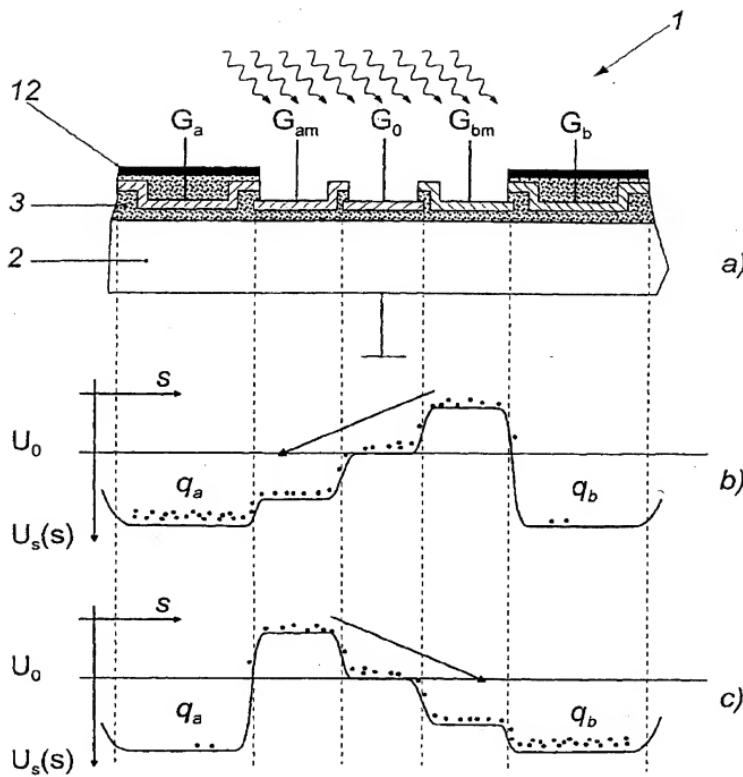


Fig. 6

【図7】

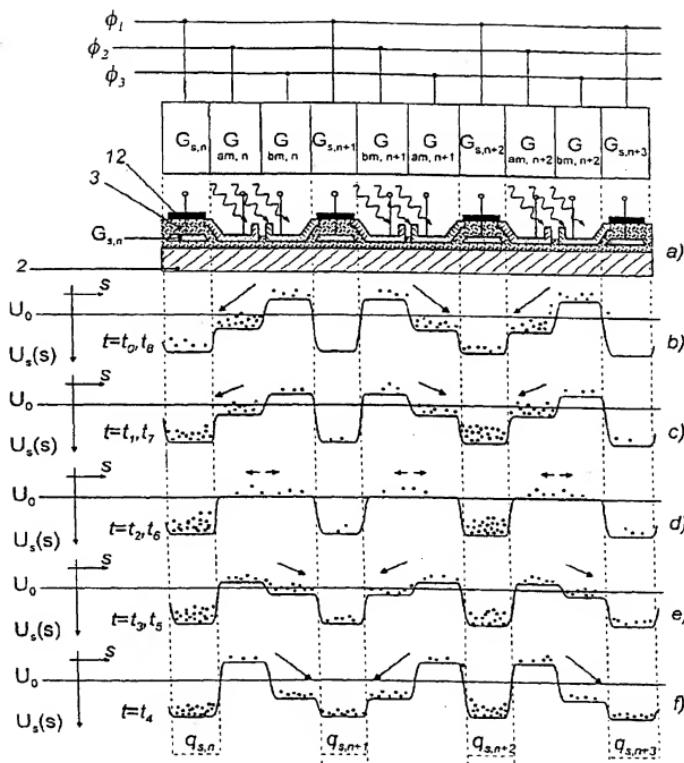
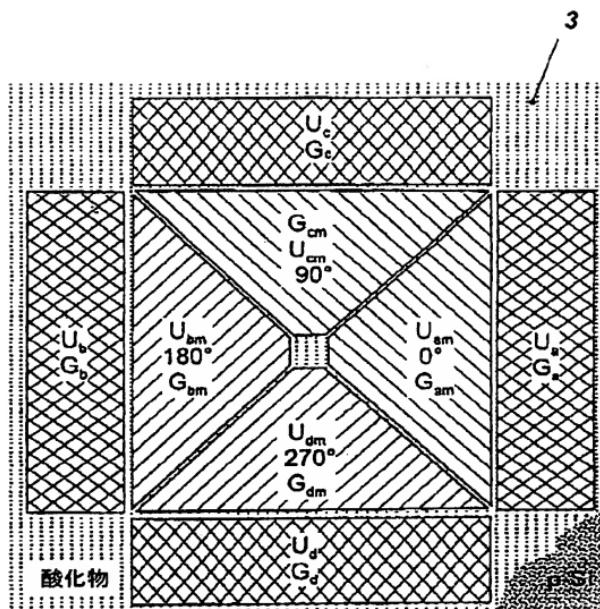


Fig. 7

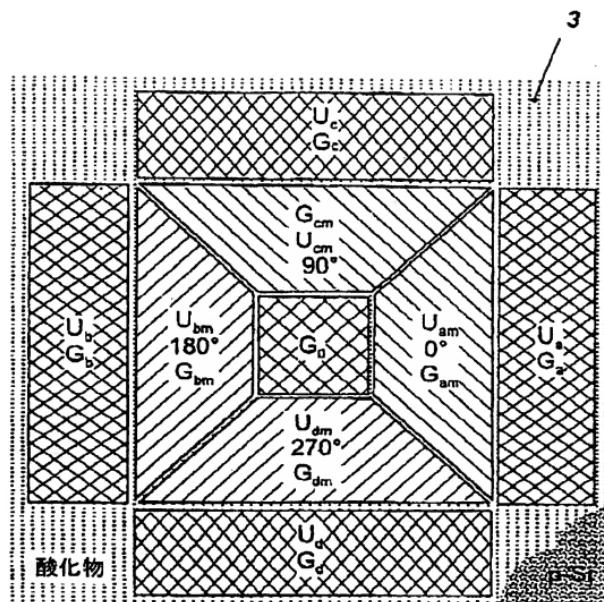
【図8】

【図8】



【図9】

【図9】



【図10】

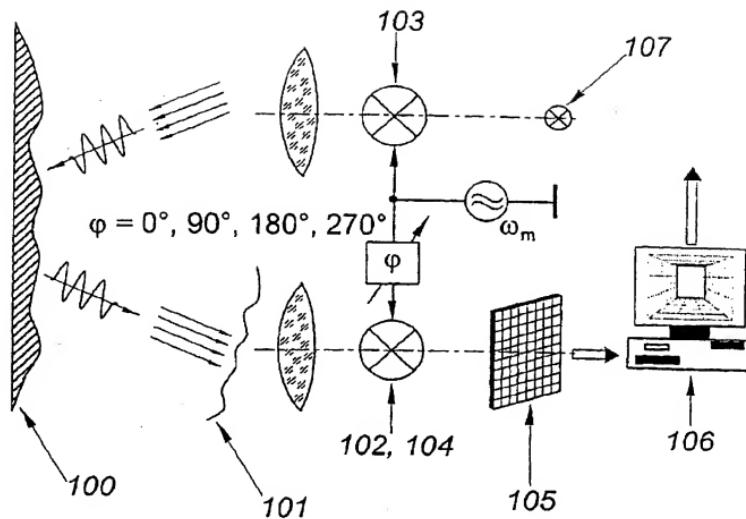


Fig. 10

【図11】

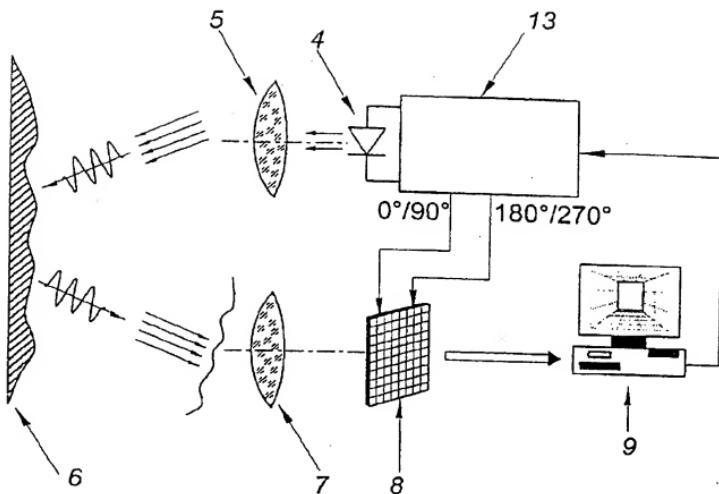


Fig. 11

【図12】

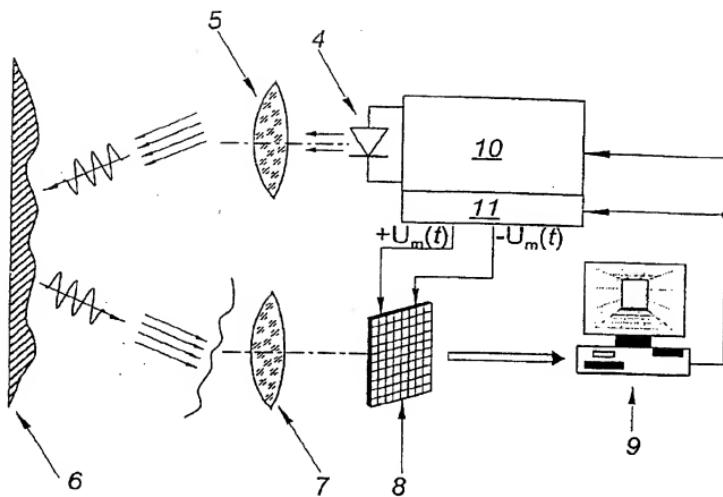


Fig. 12

【図13】

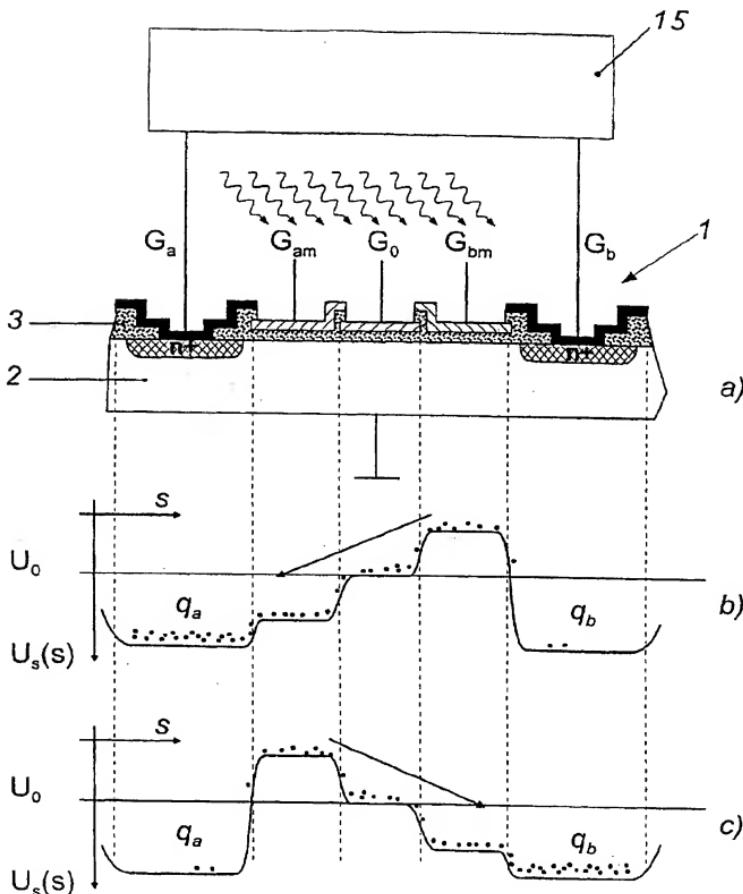
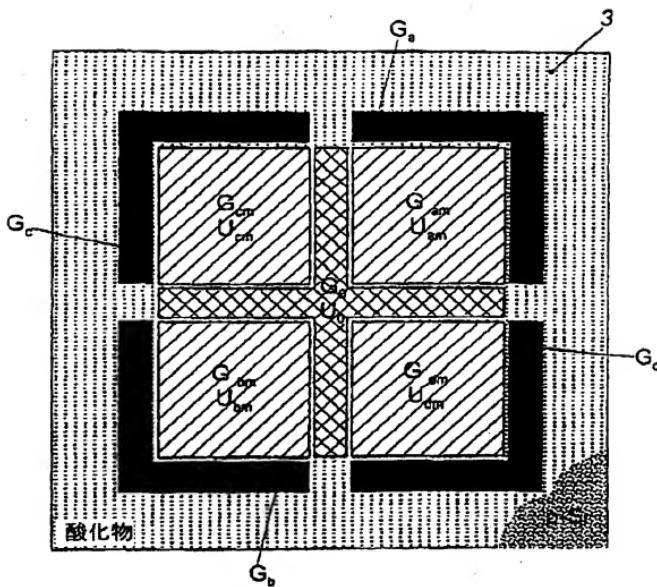


Fig. 13

【図14】

【図14】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 G01J9/00 G01B11/24 H04N3/15 H01L27/148				International Application No. PCT/DE 97/01956
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 G01J G01B H04N H01L G01S G01C				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			Relevant to claim No.	
Y	DE 44 39 298 A (SCHWARTE RUDOLF PROF DR ING) 13 June 1996 cited in the application see page 3, line 1 - line 34; claim 1 --- SPIRIG T ET AL: "THE LOCK-IN CCD - TWO-DIMENSIONAL SYNCHRONOUS DETECTION OF LIGHT" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, vol. 31, no. 9, 1 September 1995, pages 1705-1708, XP000526180 cited in the application see page 1705 - page 1706 --- - / -			1,17
	Y			
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.				<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published at or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority (claims) or which is cited to establish the publication date of another document or other special reason (as specified) "C" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other event "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed				
Date of the actual completion of the international search 7 January 1998		Date of mailing of the international search report - 6.02.98		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.O. 5818 Potsdamer 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epen, Fax. (+31-70) 340-3016		Authorized officer Breusing, J		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/DE 97/01956

C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A,P	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 003, 31 March 1997 & JP 08 313215 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 29 November 1996, see abstract ---	1
A	SUZUKI T ET AL: "REAL-TIME TWO-DIMENSIONAL SURFACE PROFILE MEASUREMENT IN A SINUSOIDAL PHASE-MODULATING LASER DIODE INTERFEROMETER" OPTICAL ENGINEERING, vol. 33, no. 8, 1 August 1994, pages 2754-2758, XP000462289 see the whole document	1
A,P	US 5 646 733 A (BIEMAN LEONARD H) 8 July 1997 see column 1 - column 2; figure 1 ---	1
A	EP 0 419 936 A (STEINBICHLER HANS) 3 April 1991 see abstract; figure 1 ---	
A	US 5 381 235 A (INOUE YASUO ET AL) 10 January 1995 see column 1; figures 1,2 -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/DE 97/01956

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4439298 A	13-06-96	NONE	
US 5646733 A	08-07-97	WO 9728421 A	07-08-97
EP 0419936 A	03-04-91	DE 3930632 A AT 106557 T DE 9017720 U DE 59005914 D JP 3175327 A US 5155363 A	14-03-91 15-06-94 14-11-91 07-07-94 30-07-91 13-10-92
US 5381235 A	10-01-95	JP 2581863 B JP 5172539 A	12-02-97 09-07-93

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, L
U, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF
, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE,
SN, TD, TG), AP(GH, KE, LS, MW, S
D, SZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG
, KZ, MD, RU, TJ, TM), AL, AM, AT
, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA,
CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, G
E, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP
, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU,
LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, N
Z, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI
, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG,
US, UZ, VN, YU, ZW

【要約の続き】

の画素を有している。該画素は、少なくとも2つの感光
変調光ゲート(G_{α} , G_{β})と、該変調光ゲートに対応
し、入射電磁波によって区分されている蓄積ゲート(G
, G_{γ})とから構成されている。複数の光混合素子をア
センブルすることによってアレイを形成できる。